## DELPHION

035576/275 (Select)

. .



RESEARCH

PRODUCTS

INSIDE DELPHION

Search: Quick/Number Boolean Advanced Der

# The Delphion Integrated View

Buy Now:

PDF | More choices

Tools: Add to Work File: Create new Work

View: INPADOC | Jump to: Top

Go to: Derwent

Ema

Create new Work

Ema

Create new Work

File: Create new Work

• DTWF015I: The execution of the system command failed at line 2992 with return code 512.

**<sup>®</sup>Title:** JP2002020689A2: PROCESS FOR PRODUCING FILM FORMING

COMPOSITION, FILM FORMING COMPOSITION, FILM FORMING PRI

AND SILICA FILM

Poerwent Title: Manufacture for coat-forming compositions for interlayer insulators involves

hydrolysis of a silane compound in presence of nitrogen onium salt

compound [Derwent Record]

PCountry: JP Japan

FKind: A2 Document Laid open to Public inspection is

ହInventor: HAYASHI EIJI;

**NISHIKAWA MICHINORI**;

YAMADA KINJI;

PAssignee: JSR CORP

News, Profiles, Stocks and More about this company

Published / Filed: 2002-01-23 / 2000-07-07

**PApplication** JP2000000206163

Number:

PIPC Code: C09D 183/04; C08G 77/06; C08K 3/28; C08K 5/05; C08K 5/06; C08K 5/17;

C08L 83/04; C09D 183/02; C09D 183/14;

Priority Number: 2000-07-07 JP2000000206163

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a film forming

composition which may form a silica film useful as an interlayer insulating film material for semiconductor elements, etc., which has a dielectric constant with little temperature dependence, shows little change in the dielectric constant after PCT(Pressure Cooker Test)

and excellent mechanical strengths.

SOLUTION: In the process for producing the film forming composition, (A) at least one silane compound chosen from the group consisting of compounds of formulae: Ra(Si)(OR1)4-a, Si (OR2)4 and R3b(R4O)3-bSi-(R7)d-Si(OR5)3-cR6c (wherein R is a hydrogen atom, a fluorine atom or a monovalent organic group; R1-R6 are each a monovalent organic group; R7 is an oxygen atom, a phenylene group or -(CH2)n-; a is an integer of 1-2; b and c are each 0-2; d is 0 or 1; and n is an integer of 1-6) is hydrolyzed in the

presence of (B) a nitrogen onium salt. COPYRIGHT: (C)2002, JPO

PFamily: None

POther Abstract CHEMABS 136(08)119965K <u>DERABS C2002-398257</u>

http://www.delphion.com/details?pn=JP22020689A2

nced Der



12/10/2005

## (19)日本国特許庁 (JP)

識別記号

(51) Int.Cl.7

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-20689 (P2002-20689A)

テーマコード(参考)

(43)公開日 平成14年1月23日(2002.1.23)

スアール株式会社内

スアール株式会社内

東京都中央区築地二丁目11番24号ジェイエ

(72)発明者 山田 欣司

C 0 9 D 183/04		C 0 9 D 183/04	4J002	
C08G 77/06		C 0 8 G 77/06	4J035	
C08K 3/28		C 0 8 K 3/28	4 J 0 3 8	
5/05		5/05		
5/06		5/06		
	審査請求	未請求 請求項の数11 OL	(全 23 頁) 最終頁に続く	
(21)出願番号	特顧2000-206163(P2000-206163)	(71)出願人 000004178 ジェイエスア-	ール株式会社	
(22)出願日	平成12年7月7日(2000.7.7)			
		(72)発明者 林 英治		
		東京都中央区勢	築地二丁目11番24号ジェイエ	
		スアール株式会	会社内	
		(72)発明者 西川 通則		
		東京都中央区領	築地二丁目11番24号ジェイエ	

FΙ

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 膜形成用組成物の製造方法、膜形成用組成物、膜の形成方法およびシリカ系膜

## (57)【要約】 (修正有)

【課題】 半導体素子などにおける層間絶縁膜材料として、塗膜の比誘電率の温度依存性が小さく、PCT (Pressure Cooker Test)後の比誘電率変化が少なく、かつ塗膜の機械的強度に優れたシリカ系膜が形成可能な膜形成用組成物を得る。

【解決手段】 (A)下記一般式(1)、(2)、(3)で表される化合物の群から選ばれた少なくとも1種のシラン化合物、(B)窒素オニウム塩化合物の存在化で加水分解する事を特徴とする膜形成用組成物の製造方法。

 $R_a$  (Si)(OR<sup>1</sup>)<sub>4-a</sub>·····(1)

Si (OR<sup>2</sup>), ·····(2)

R<sup>3</sup>。(R<sup>4</sup>O), <sub>-</sub> Si – (R<sup>7</sup>) <sub>a</sub> – Si (OR<sup>3</sup>), <sub>-</sub> 、R<sup>3</sup>。・・・・・(3) (式中R は水紫原子、フッ紫原子、又は一価の有機基、

 $R^1 \sim R^0$  は一価の有機基、 $R^7$  は酸素原子、フェニレン基又は $-(CH_2)$ 。 $-、aは1\sim2$ の整数、b、 $cは0\sim2$ の数、dは0又は1、 $nは1\sim6$ の整数を示す。)

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A)下記一般式(1)で表される化 合物、下記一般式(2)で表される化合物および下記一 般式(3)で表される化合物の群から選ばれた少なくと も1種のシラン化合物を、

$$R^{3}$$
,  $(R^{4}O)$ ,  $Si - (R^{7})$ , -

〔式中、 $R' \sim R'$  は同一または異なり、それぞれ1価 の有機基、bおよびcは同一または異なり、0~2の数 を示し、R'は酸素原子、フェニレン基または-(CH 」)。 - で表される基(ととで、nは1~6の整数であ 10 載の膜形成用組成物の製造方法。 る)、dは0または1を示す。)

(B) 窒素オニウム塩化合物の存在下で加水分解すると とを特徴とする膜形成用組成物の製造方法。

【請求項2】 (B)窒素オニウム塩化合物が(B- ※

(式中、R°~R¹¹は同一または異なり、それぞれ水素 原子、炭素数1~10のアルキル基、ヒドロキシアルキ ル基、アリール基、アリールアルキル基を示し、R11は ハロゲン原子、1~4価のアニオン性基を示し、eは1 ~4の整数を示し、R11は窒素原子を含有するg価の環 状カチオン性基を示し、R''はハロゲン原子、f 価のア ニオン性基を示し、fは1~4の整数、gは1~fの整 数を示し、g・h≦fである。)

【請求項4】 (B)成分の使用量が、(A)成分中の アルコキシル基の総量1モルに対して0.0001~ 1 モルであることを特徴とする請求項 1 記載の膜形成用 組成物。

【請求項5】 加水分解時の(A)成分の濃度が0.5 ~10重量%(完全加水分解縮合物換算)であることを★30

R''O (CHCH, CH, O) R''

(R''およびR''は、それぞれ独立して水素原子、炭素 数1~4のアルキル基またはCH,CO-から選ばれる 1価の有機基を示し、gは1~2の整数を表す。) 【請求項10】 請求項8項記載の膜形成用組成物を基 板に塗布し、加熱することを特徴とする膜の形成方法。 【請求項11】 請求項10記載の膜の形成方法によって 得られるシリカ系膜。

#### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、膜形成用組成物の 製造法とそれを用いた膜形成用組成物に関し、さらに詳 しくは、半導体素子などにおける層間絶縁膜材料とし て、塗膜の比誘電率の温度依存性が小さく、PCT(Pr essure Cooker Test)後の比誘電率変化が少なく、かつ 塗膜の機械的強度に優れたシリカ系膜が形成可能な膜形 成用組成物に関する。

### [0002]

【従来の技術】従来、半導体素子などにおける層間絶縁 膜として、CVD法などの真空プロセスで形成されたシ 50 をアンモニアの存在下縮合することにより得られた塗布

\*R.Si (OR'),...  $\cdots \cdots (1)$ 

(式中、Rは水素原子、フッ素原子または1価の有機 基、R1 は1価の有機基、aは1~2の整数を示す。) Si(OR').  $\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$ 

(式中、R'は1価の有機基を示す。)

 $R^{3}_{b}(R^{4}O)_{3-b}Si-(R^{7})_{4}-Si(OR^{5})_{3-c}R^{5}_{c}\cdots (3)$ 

※1) 窒素含有化合物と(B-2) アニオン性基含有化合 物およびハロゲン化合物から選ばれる少なくとも1種と から形成されるものであることを特徴とする請求項1記

【請求項3】(B)成分が、下記一般式(4)で表され る化合物および(5)で表される化合物から選ばれる少 なくとも1種であることを特徴とする請求項1記載の膜 形成用組成物の製造方法。

## $\cdots (4)$

 $\cdots (5)$ 

★特徴とする請求項1記載の膜形成用組成物の製造方法。 【請求項6】 さらに (C) 水および (D) 沸点 100 ℃以下のアルコールの存在下に(A)成分を加水分解す 20 ることを特徴とする請求項1記載の膜形成用組成物の製 造方法。

【請求項7】 (C)水の使用量が、(A)成分1モル に対して0.5~150モルであることを特徴とする請 求項1記載の膜形成用組成物の製造方法。

【請求項8】 請求項1~6記載の製造方法で得られる 膜形成用組成物。

【請求項9】 (E)下記一般式(6)で表される溶剤 を含有することを特徴とする請求項7記載の膜形成用組 成物。

#### $\cdots (6)$

リカ(SiO,)膜が多用されている。そして、近年、 より均一な層間絶縁膜を形成することを目的として、S OG(Spin on Glass)膜と呼ばれるテト ラアルコキシランの加水分解生成物を主成分とする塗布 型の絶縁膜も使用されるようになっている。また、半導 体素子などの髙集積化に伴い、有機SOGと呼ばれるボ リオルガノシロキサンを主成分とする低比誘電率の層間 絶縁膜が開発されている。特に半導体素子などのさらな 40 る高集積化や多層化に伴い、より優れた導体間の電気絶 縁性が要求されており、したがって、塗膜の比誘電率の 温度依存性が小さく、PCT後の比誘電率変化が少な く、かつ塗膜の機械的強度に優れた層間絶縁膜材料が求 められるようになっている。

【0003】低比誘電率の材料としては、アンモニアの 存在下にアルコキシシランを縮合して得られる微粒子と アルコキシシランの塩基性部分加水分解物との混合物か らなる組成物(特開平5-263045、同5-315 319)や、ポリアルコキシシランの塩基性加水分解物

液(特開平11-340219、同11-34022 0)が提案されているが、これらの方法で得られる材料 は、反応の生成物の性質が安定せず、塗膜の比誘電率の 温度依存性、PCT後の比誘電率変化、塗膜の機械的強 度などの膜特性のバラツキも大きいため、工業的生産に は不向きであった。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点 を解決するための膜形成用組成物に関し、さらに詳しく は、半導体素子などにおける層間絶縁膜として、塗膜の 10 比誘電率の温度依存性が小さく、PCT後の比誘電率変 化が少なく、かつ塗膜の機械的強度に優れた膜形成用組 成物および該組成物から得られるシリカ系膜を提供する\*

$$R^{3}_{b}$$
 (R<sup>4</sup> O)<sub>3-b</sub> S i - (R<sup>7</sup> 3)

〔式中、 $R^3 \sim R^6$  は同一または異なり、それぞれ1価 の有機基、bおよびcは同一または異なり、0~2の数 を示し、R'は酸素原子、フェニレン基または-(CH 、)。-で表される基(CCで、nは1~6の整数であ る)、dは0または1を示す。)

(B) 窒素オニウム塩化合物の存在下で加水分解すると とを特徴とする膜形成用組成物の製造方法に関する。次 に、本発明は、上記製造方法で得られる膜形成用組成物 に関する。次に、本発明は、上記膜形成用組成物を基板 に塗布し、加熱することを特徴とする膜の形成方法に関 する。次に、本発明は、上記膜の形成方法によって得ら れるシリカ系膜に関する。

## [0006]

【発明の実施の形態】本発明において、(A)成分の加 選ばれた少なくとも1種の加水分解物縮合物である。と とで、(A)成分における加水分解物とは、上記(A) 成分を構成する化合物(1)~(3) に含まれるR¹O -基, R' O-基, R' O-基およびR' O-基のすべ てが加水分解されている必要はなく、例えば、1個だけ が加水分解されているもの、2個以上が加水分解されて いるもの、あるいは、これらの混合物であってもよい。 また、(A)成分における縮合物は、(A)成分を構成 する化合物(1)~(3)の加水分解物のシラノール基 が縮合してSi-〇-Si結合を形成したものである が、本発明では、シラノール基がすべて縮合している必 要はなく、僅かな一部のシラノール基が縮合したもの、 縮合の程度が異なっているものの混合物などをも包含し た概念である。

【0007】化合物(1);上記一般式(1)におい て、RおよびR<sup>1</sup>の1価の有機基としては、アルキル 基、アリール基、アリル基、グリシジル基などを挙げる ことができる。また、一般式(1)において、Rは1価 の有機基、特にアルキル基またはフェニル基であるとと が好ましい。ととで、アルキル基としては、メチル基、

\*ことを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、(A)下記一 般式(1)で表される化合物(以下、「化合物1」とも いう)、下記一般式(2)で表される化合物(以下、 「化合物2」ともいう)および下記一般式(3)(以 下、「化合物3」ともいう)で表される化合物の群から 選ばれた少なくとも1種のシラン化合物を R. Si (OR1)...  $\cdots \cdots (1)$ (式中、Rは水素原子、フッ素原子または1価の有機 基、R1 は1価の有機基、aは1~2の整数を示す。) Si (OR'),  $\cdots (2)$ (式中、R'は1価の有機基を示す。)

 $R^{3}$  b  $(R^{4} O)_{3-b} Si - (R^{7})_{4} - Si (OR^{5})_{3-c} R^{6} \cdot \cdot \cdot \cdot ($ 

エチル基、プロピル基、ブチル基などが挙げられ、好ま しくは炭素数1~5であり、これらのアルキル基は鎖状 でも、分岐していてもよく、さらに水素原子がフッ素原 子などに置換されていてもよい。一般式(1)におい 20 て、アリール基としては、フェニル基、ナフチル基、メ チルフェニル基、エチルフェニル基、クロロフェニル 基、ブロモフェニル基、フルオロフェニル基などを挙げ ることができる。

【0008】一般式(1)で表される化合物の具体例と しては、トリメトキシシラン、トリエトキシジラン、ト リーn-プロポキシシラン、トリーiso-プロポキシ シラン、トリーnープトキシシラン、トリーsec-ブ トキシシラン、トリーtert‐ブトキシシラン、トリ フェノキシシラン、フルオロトリメトキシシラン、フル 水分解縮合物とは、上記化合物(1)~(3)の群から 30 オロトリエトキシシラン、フルオロトリーn-プロポキ シシラン、フルオロトリーisoープロポキシシラン、 フルオロトリーnーブトキシシラン、フルオロトリーs ecープトキシシラン、フルオロトリーtertープト キシシラン、フルオロトリフェノキシシランなど: 【0009】メチルトリメトキシシラン、メチルトリエ トキシシラン、メチルトリーn-プロポキシシラン、メ チルトリーiso-プロポキシシラン、メチルトリーn - ブトキシシラン、メチルトリー s e c - ブトキシシラ ン、メチルトリーtert-プトキシシラン、メチルト 40 リフェノキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチ ルトリエトキシシラン、エチルトリーn-プロポキシシ ラン、エチルトリー i s o - プロポキシシラン、エチル トリーnープトキシシラン、エチルトリーsecープト キシシラン、エチルトリーtert‐ブトキシシラン、 エチルトリフェノキシシラン、ピニルトリメトキシシラ ン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリーnープロ ポキシシラン、ビニルトリーiso-プロポキシシラ ン、ビニルトリーn – ブトキシシラン、ビニルトリー s ecーブトキシシラン、ビニルトリーtertーブトキ 50 シシラン、ピニルトリフェノキシシラン、n-プロピル

トリメトキシシラン、n-プロビルトリエトキシシラ ン、nープロピルトリーnープロポキシシラン、nープ ロビルトリーiso-プロポキシシラン、n-プロビル トリーnープトキシシラン、nープロピルトリーsec ーブトキシシラン、n-プロピルトリーtert-ブト キシシラン、n-プロピルトリフェノキシシラン、i-プロピルトリメトキシシラン、i-プロピルトリエトキ シシラン、i-プロピルトリ-n-プロポキシシラン、 i-プロピルトリーiso-プロポキシシラン、i-プ ロピルトリーn-ブトキシシラン、i-プロピルトリー 10 sec-プトキシシラン、i-プロピルトリーtert -ブトキシシラン、i-プロピルトリフェノキシシラ ン、nープチルトリメトキシシラン、nープチルトリエ トキシシラン、n-ブチルトリ-n-プロポキシシラ ン、n-ブチルトリーiso-プロポキシシラン、n-ブチルトリーn - ブトキシシラン、n - ブチルトリーs ec-ブトキシシラン、n-ブチルトリーtert-ブ トキシシラン、n-ブチルトリフェノキシシラン、se c-ブチルトリメトキシシラン、sec-ブチルトリエ シラン、sec‐ブチルートリーiso‐プロポキシシ ラン、sec-ブチルートリーn-ブトキシシラン、s ec-ブチルートリーsec-ブトキシシラン、sec ープチルートリーtertープトキシシラン、sec-ブチルートリフェノキシシラン、t-ブチルトリメトキ シシラン、t-ブチルトリエトキシシラン、t-ブチル トリーnープロポキシシラン、tーブチルトリーiso -プロポキシシラン、t-ブチルトリーn-ブトキシシ ラン、t-ブチルトリーsec-ブトキシシラン、t-リフェノキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フ ェニルトリエトキシシラン、フェニルトリーn-プロボ キシシラン、フェニルトリーiso-プロポキシシラ ン、フェニルトリーnーブトキシシラン、フェニルトリ - s e c - ブトキシシラン、フェニルトリーtert-ブトキシシラン、フェニルトリフェノキシシラン、ビニ ルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ア -アミノプロビルトリメトキシシラン、*γ*-アミノプロ ピルトリエトキシシラン、アーグリシドキシプロピルト リメトキシシラン、ケーグリシドキシプロピルトリエト キシシラン、ケートリフロロプロピルトリメトキシシラ ン、ァートリフロロプロピルトリエトキシシランなど; 【0010】ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジェ トキシシラン、ジメチルージーnープロポキシシラン、 ジメチルージーiso-プロポキシシラン、ジメチルー ジーnーブトキシシラン、ジメチルージーsecーブト キシシラン、ジメチルージー tertーブトキシシラ ン、ジメチルジフェノキシシラン、ジエチルジメトキシ シラン、ジェチルジェトキシシラン、ジェチルージーn -プロポキシシラン、ジエチルージーiso-プロポキ 50 チルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、

シシラン、ジエチルージーnーブトキシシラン、ジエチ ルージーSecーブトキシシラン、ジエチルージーte rtープトキシシラン、ジエチルジフェノキシシラン、 ジーnープロピルジメトキシシラン、ジーnープロピル ジエトキシシラン、ジーnープロピルージーnープロポ キシシラン、ジーn-プロピルージーiso-プロポキ シシラン、ジーnープロピルージーnーブトキシシラ ン、ジーnープロビルージーsecーブトキシシラン、 ジーnープロビルージーtertーブトキシシラン、ジ -n-プロピルージーフェノキシシラン、ジーiso-プロビルジメトキシシラン、ジーiso-プロビルジェ トキシシラン、ジーiso-プロビルージーn-プロポ キシシラン、ジーiso-プロピルージーiso-プロ ポキシシラン、ジーiso-プロピルージーn-ブトキ シシラン、ジーiso-プロピルージーsec-ブトキ シシラン、ジーiso-プロピルージーtert-ブト キシシラン、ジーiso-プロピルージーフェノキシシ ラン、ジ-n-ブチルジメトキシシラン、ジ-n-ブチ ルジエトキシシラン、ジ-n-ブチル-ジ-n-プロボ トキシシラン、sec‐ブチル‐トリ‐n‐プロポキシ 20 キシシラン、ジ‐n‐ブチル‐ジ‐iso‐プロポキシ シラン、ジーnーブチルージーnーブトキシシラン、ジ - n - プチルージー s e c - ブトキシシラン、ジー n -ブチルージーtertーブトキシシラン、ジーnーブチ ルージーフェノキシシラン、ジーsec-ブチルジメト キシシラン、ジーsec-ブチルジエトキシシラン、ジ -sec-ブチルージ-n-プロポキシシラン、ジ-s ecーブチルージーisoープロポキシシラン、ジーs ecーブチルージーnーブトキシシラン、ジーsecー ブチルージーsec-ブトキシシラン、ジーsec-ブ プチルトリー t e r t -  $\overline{\textit{T}}$  t +  $\overline{\textit{T}}$   $\hat{\textit{T}}$   $\hat{\textit{T}}$ チルージーフェノキシシラン、ジーtertーブチルジ メトキシシラン、ジーtert - ブチルジェトキシシラ ン、ジーtert-ブチルージーn-プロポキシシラ ン、ジーtert‐ブチルージーiso‐プロポキシシ ラン、ジーtertーブチルージーnーブトキシシラ ン、ジーtert~ブチルージーsec-ブトキシシラ ン、ジーtert-ブチルージーtert-ブトキシシ ラン、ジーtertーブチルージーフェノキシシラン、 ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルージーエトキ 40 シシラン、ジフェニルージーnープロポキシシラン、ジ フェニルージーiso-プロポキシシラン、ジフェニル -ジ-n-ブトキシシラン、ジフェニル-ジ-sec-ブトキシシラン、ジフェニルージーtert-ブトキシ シラン、ジフェニルジフェノキシシラン、ジビニルトリ メトキシシランなど;を挙げることができる。 【0011】化合物(1)として好ましい化合物は、メ チルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、 メチルトリーnープロポキシシラン、メチルトリーis 0-プロポキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エ

ビニルトリエトキシシラン、フェニルトリメトキシシラ ン、フェニルトリエトキシシラン、ジメチルジメトキシ シラン、ジメチルジエトキシシラン、ジエチルジメトキ シシラン、ジエチルジエトキシシラン、ジフェニルジメ トキシシラン、ジフェニルジエトキシシランなどであ る。これらは、1種あるいは2種以上を同時に使用して もよい。

【0012】化合物(2);上記一般式(2)におい て、R'で表される1価の有機基としては、先の一般式 (1)と同様な有機基を挙げることができる。一般式 (2)で表される化合物の具体例としては、テトラメト キシシラン、テトラエトキシシラン、テトラーn-プロ ポキシシラン、テトラーiso-プロポキシシラン、テ トラーn-ブトキシラン、テトラーsec-ブトキシシ ラン、テトラーtert-ブトキシシラン、テトラフェ ノキシシランなどが挙げられる。

【0013】化合物(3);上記一般式(3)におい て、R'~R'で表される1価の有機基としては、先の 一般式(1)と同様な有機基を挙げることができる。一 般式(3)のうち、R'が酸素原子の化合物としては、 ヘキサメトキシジシロキサン、ヘキサエトキシジシロキ サン、ヘキサフェノキシジシロキサン、1,1,1, 3, 3-ペンタメトキシ-3-メチルジシロキサン、 1, 1, 1, 3, 3-ペンタエトキシー3-メチルジシ ロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタフェノキシ-3 ーメチルジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3ーペンタメ トキシー3-エチルジシロキサン、1,1,1,3,3 -ペンタエトキシ-3-エチルジシロキサン、1,1, 1, 3, 3-ペンタフェノキシ-3-エチルジシロキサ ン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタメトキシ-3-フェニ 30 ることができる。 ルジシロキサン、1、1、1、3、3-ペンタエトキシ -3-フェニルジシロキサン、1,1,1,3,3-ペ ンタフェノキシー3-フェニルジシロキサン、1,1, 3, 3-テトラメトキシ-1, 3-ジメチルジシロキサ (2, 1, 1, 3, 3-5+5)ルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラフェノキシー 1, 3-ジメチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テト ラメトキシー1, 3-ジエチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラエトキシー1, 3-ジエチルジシロキサ ン、1, 1, 3, 3 - テトラフェノキシ-1, 3 - ジエ 40 チルジシロキサン、1,1,3,3-テトラメトキシー 1, 3-ジフェニルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テ トラエトキシー1, 3-ジフェニルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラフェノキシー1, 3-ジフェニルジ シロキサン、1、1、3-トリメトキシ-1、3、3-トリメチルジシロキサン、1,1,3-トリエトキシー 1, 3, 3-トリメチルジシロキサン、1, 1, 3-ト リフェノキシー1,3,3-トリメチルジシロキサン 1, 1, 3-トリメトキシー1, 3, 3-トリエチルジ

-トリエチルジシロキサン、、1,1,3-トリフェノ キシー1, 3, 3-トリエチルジシロキサン、、1, 1, 3-トリメトキシ-1, 3, 3-トリフェニルジシ ロキサン、1、1、3-トリエトキシ-1、3、3-ト リフェニルジシロキサン、1、1、3-トリフェノキシ -1, 3, 3-トリフェニルジシロキサン、1, 3-ジ ン、1, 3-ジエトキシ-1, 1, 3, 3-テトラメチ ルジシロキサン、1,3-ジフェノキシ-1,1,3, 10 3-テトラメチルジシロキサン、1,3-ジメトキシー 1, 1, 3, 3-テトラエチルジシロキサン、1, 3-ジエトキシー1, 1, 3, 3-テトラエチルジシロキサ ン、1, 3 - ジフェノキシ - 1, 1, 3, 3 - テトラエ チルジシロキサン、1,3-ジメトキシ-1,1,3, 3-テトラフェニルジシロキサン、1、3-ジェトキシ、 -1, 1, 3, 3-テトラフェニルジシロキサン、1, 3-ジフェノキシー1, 1, 3, 3-テトラフェニルジ シロキサンなどを挙げることができる。

【0014】 これらのうち、ヘキサメトキシジシロキサ 20 ン、ヘキサエトキシジシロキサン、1、1、3、3-テ トラメトキシー1,3-ジメチルジシロキサン、1. 1, 3, 3-テトラエトキシ-1, 3-ジメチルジシロ キサン、1, 1, 3, 3-テトラメトキシ-1, 3-ジ フェニルジシロキサン、1,3-ジメトキシ-1,1. 3, 3-テトラメチルジシロキサン、1, 3-ジェトキ シ-1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、1, 3-ジメトキシー1, 1, 3, 3-テトラフェニルジシ ロキサン、1,3-ジェトキシー1,1,3,3-テト ラフェニルジシロキサンなどを、好ましい例として挙げ

【0015】また、一般式 (3) において、dが0の化 合物としては、ヘキサメトキシジシラン、ヘキサエトキ シジシラン、ヘキサフェノキシジシラン、1,1,1,1 2,2-ペンタメトキシ-2-メチルジシラン、1. 1, 1, 2, 2-ペンタエトキシー2-メチルジシラ ン、1、1、1、2、2 - ペンタフェノキシー2 - メチ ルジシラン、1, 1, 1, 2, 2-ベンタメトキシー2. -エチルジシラン、1, 1, 1, 2, 2-ペンタエトキ シー2-エチルジシラン、1,1,1,2,2-ペンタ フェノキシー2ーエチルジシラン、1,1,1,2,2 -ペンタメトキシ-2-フェニルジシラン、1、1、 1, 2, 2-ペンタエトキシ-2-フェニルジシラン、 1, 1, 1, 2, 2-ペンタフェノキシー2-フェニル ジシラン、1, 1, 2, 2-テトラメトキシー1, 2-ジメチルジシラン、1,1,2,2-テトラエトキシー 1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラフ ェノキシー1,2-ジメチルジシラン、1,1,2,2 -テトラメトキシ−1,2−ジエチルジシラン、1. 1, 2, 2-テトラエトキシ-1, 2-ジェチルジシラ シロキサン、、1, 1, 3-トリエトキシ-1, 3, 3 50 ン、1, 1, 2, 2-テトラフェノキシ-1, 2-ジェ

(6) ·

チルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラメトキシー1.2-ジフェニルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラエト キシー1, 2-ジフェニルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラフェノキシー1,2-ジフェニルジシラン、1, 1, 2-トリメトキシー1, 2, 2-トリメチルジシラ ン、1, 1, 2-トリエトキシー1, 2, 2-トリメチ ルジシラン、1, 1, 2-トリフェノキシー1, 2, 2 -トリメチルジシラン、1,1,2-トリメトキシー 1, 2, 2-トリエチルジシラン、、1, 1, 2-トリ エトキシー1, 2, 2ートリエチルジシラン、、1. 1, 2-トリフェノキシ-1, 2, 2-トリエチルジシ ラン、、1, 1, 2-トリメトキシ-1, 2, 2-トリ フェニルジシラン、1, 1, 2 -トリエトキシ-1. 2, 2-トリフェニルジシラン、、1, 1, 2-トリフ ェノキシー1, 2, 2-トリフェニルジシラン、1, 2 -ジメトキシ-1, 1, 2, 2-テトラメチルジシラ ルジシラン、1,2-ジフェノキシ-1,1,2,2-テトラメチルジシラン、1,2-ジメトキシ-1,1, 2, 2-テトラエチルジシラン、1, 2-ジエトキシー 20 1, 1, 2, 2-テトラエチルジシラン、1, 2-ジフ ェノキシー1, 1, 2, 2ーテトラエチルジシラン、 1, 2-ジメトキシー1, 1, 2, 2-テトラフェニル ジシラン、1,2-ジェトキシ-1,1,2,2-テト ラフェニルジシラン、1,2-ジフェノキシ-1,1, 2. 2-テトラフェニルジシランなどを挙げることがで きる。

【0016】 これらのうち、ヘキサメトキシジシラン、 ヘキサエトキシジシラン、1, 1, 2, 2-テトラメト トラエトキシー1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラメトキシ-1, 2-ジフェニルジシラ ルジシラン、1,2-ジエトキシ-1,1,2,2-テ トラメチルジシラン、1、2-ジメトキシー1、1、 2, 2-テトラフェニルジシラン、1, 2-ジェトキシ -1, 1, 2, 2-テトラフェニルジシランなどを、好 ましい例として挙げることができる。

【0017】さらに、一般式(3)において、R'が-(CH<sub>2</sub>)。-で表される基の化合物としては、ビス (トリメトキシシリル) メタン、ビス (トリエトキシシ リル)メタン、ビス(トリーnープロポキシシリル)メ タン、ビス(トリーi-プロポキシシリル)メタン、ビ ス(トリーn-ブトキシシリル) メタン、ビス(トリー Sec‐ブトキシシリル) メタン、ビス (トリーt‐ブ トキシシリル) メタン、1,2-ビス(トリメトキシシ リル) エタン、1、2-ビス (トリエトキシシリル) エ タン、1,2-ビス(トリーn-プロポキシシリル)エ タン、1, 2-ビス(トリーi-プロポキシシリル)ェ タン、1, 2-ビス(トリ-n-ブトキシシリル)エタ 50 1, 3-ビス(トリ-sec-ブトキシシリル)ベンゼ

ン、1, 2-ビス (トリ-sec-ブトキシシリル)ェ タン、1, 2-ビス (トリーt-ブトキシシリル) エタ ン、1-(ジメトキシメチルシリル)-1-(トリメト キシシリル) メタン、1-(ジエトキシメチルシリル) -1-(トリエトキシシリル)メタン、1-(ジ-n-プロポキシメチルシリル) -1- (トリ-n-プロポキ シシリル)メタン、1-(ジ-i-プロポキシメチルシ リル)-1-(トリーi-プロポキシシリル)メタン、 1-(ジ-n-ブトキシメチルシリル)-1-(トリー 10 n-プトキシシリル) メタン、1-(ジ-sec-ブト キシメチルシリル) -1-(トリ-sec-ブトキシシ リル) メタン、1-(ジ-t-ブトキシメチルシリル) -1-(トリーt-ブトキシシリル) メタン、1-(ジ メトキシメチルシリル)-2~(トリメトキシシリル) エタン、1-(ジエトキシメチルシリル)-2-(トリ エトキシシリル) エタン、1-(ジ-n-プロポキシメ チルシリル) -2-(トリーn-プロポキシシリル) エ タン、1-(ジ-i-プロポキシメチルシリル)-2-(トリーi-プロポキシシリル) エタン、1-(ジ-n -ブトキシメチルシリル) -2-(トリ-n-ブトキシ シリル) エタン、1-(ジ-sec-ブトキシメチルシ リル) -2-(トリーsec-ブトキシシリル) エタ ン、1-(ジ-t-ブトキシメチルシリル)-2-(ト リー t - ブトキシシリル) エタン、ビス (ジメトキシメ チルシリル)メタン、ビス(ジエトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジーnープロポキシメチルシリル) メタ ン、ビス (ジーi-プロポキシメチルシリル) メタン、 ビス (ジーn-ブトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジ-sec-ブトキシメチルシリル) メタン、ビス キシー1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2-テ 30 (ジーt-プトキシメチルシリル) メタン、1, 2-ビ ス(ジメトキシメチルシリル)エタン、1,2-ビス (ジエトキシメチルシリル) エタン、1,2-ビス(ジ -n-プロポキシメチルシリル) エタン、1,2-ビス (ジ-i-プロポキシメチルシリル) エタン、1,2-ビス (ジーn ~ ブトキシメチルシリル) エタン、1、2 -ビス (ジーsec-ブトキシメチルシリル) エタン、 1, 2-ビス (ジーt-ブトキシメチルシリル) エタ ン、1、2~ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、 1, 2-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1, 2 40 -ビス(トリーn-プロポキシシリル)ベンゼン 1. 2-ビス (トリーi-プロポキシシリル) ベンゼン、 1,2-ビス(トリーn-ブトキシシリル)ベンゼン、 1,2-ビス(トリーsec-ブトキシシリル)ベンゼ ン、1,2-ビス(トリ-t-ブトキシシリル)ベンゼ ン、1,3-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、 1, 3-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1,3 -ビス(トリーn-プロポキシシリル)ベンゼン、1, 3-ビス(トリーi-プロポキシシリル)ベンゼン、 1,3-ビス(トリーn-ブトキシシリル)ベンゼン、

ン、1、3-ビス(トリーt-ブトキシシリル)ベンゼ ン、1,4-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン 1, 4-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1, 4 ービス(トリーnープロポキシシリル)ベンゼン、1. 4-ビス(トリーi-プロポキシシリル)ベンゼン、 1.4-ビス(トリーn-ブトキシシリル)ベンゼン、 1, 4-ビス(トリーsec-ブトキシシリル)ベンゼ ン、1, 4 - ピス(トリーt - ブトキシシリル)ベンゼ ンなど挙げることができる。

【0018】 これらのうち、ビス(トリメトキシシリ ル) メタン、ビス(トリエトキシシリル)メタン、1、 2-ビス(トリメトキシシリル)エタン、1,2-ビス (トリエトキシシリル) エタン、1-(ジメトキシメチ ルシリル)-1-(トリメトキシシリル)メタン、1-(ジエトキシメチルシリル) -1 - (トリエトキシシリ ル) メタン、1-(ジメトキシメチルシリル)-2-(トリメトキシシリル) エタン、1-(ジェトキシメチ ルシリル)-2-(トリエトキシシリル)エタン、ビス (ジメトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジェトキシ メチルシリル) メタン、1、2 - ビス (ジメトキシメチ 20 ルシリル) エタン、1,2-ビス (ジエトキシメチルシ リル) エタン、1、2-ビス (トリメトキシシリル) ベ ンゼン、1,2-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼ ン、1、3-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、 1. 3-ピス(トリエトキシシリル)ベンゼン 1. 4 -ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、1,4-ビス (トリエトキシシリル) ベンゼンなどを好ましい例とし て挙げるととができる。本発明において、(A)成分を 構成する化合物(1)~(3)としては、上記化合物 用いることができる。なお、(A)成分中、各成分を完 全加水分解縮合物に換算したときに、化合物(2)は、\*

> (R'R'R''R'' N), R'' R13 (R14) h

(式中、R\*~R\*1は同一または異なり、それぞれ水素 原子、炭素数1~10のアルキル基、ヒドロキシアルキ ル基、アリール基、アリールアルキル基を示し、R<sup>11</sup>は ハロゲン原子、1~4価のアニオン性基を示し、eは1 ~4の整数を示し、R11は窒素原子を含有するg 価の環 状カチオン性基を示し、R11はハロゲン原子、f価のア ニオン性基を示し、fは1~4の整数、gは1~fの整 数を示し、g·h≦fである。)

上記において炭素数1~10のアルキル基としては、メ チル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ヘキシル基 などを、アリール基としては、フェニル基、トリル基な どを、アリールアルキル基としては、ベンジル基など を、ハロゲン原子としては塩素原子、臭素原子などを示 す。1~4価のアニオン性基とは、1~4個のアニオン 性基を有する化合物に由来する基であり、窒素原子を含

\*化合物(1)~(3)の総量中、5~75重量%、好ま しくは10~70重量%、さらに好ましくは15~70 重量%である。また、化合物(1)および/または (3)は、化合物(1)~(3)の総量中、95~25 重量%、好ましくは90~30重量%、さらに好ましく は85~30重量%である。化合物(2)が、化合物 (1)~(3)の総量中、5~75重量%であること が、得られる塗膜の弾性率が高く、かつ低誘電性に特に 優れる。ととで、本発明において、完全加水分解縮合物 10 とは、化合物(1)~(3)中のR<sup>1</sup>O-基, R<sup>1</sup>O-基、R'O-基およびR'O-基が100%加水分解し てSiOH基となり、さらに完全に縮合してシロキサン 構造となったものをいう。また、(A)成分としては、 得られる組成物の貯蔵安定性がより優れるので、化合物 (1)および化合物(2)の加水分解縮合物であること が好ましい。

【0019】本発明の(A)加水分解縮合物を製造する に際しては、上記化合物(1)~(3)の群から選ばれ た少なくとも1種のシラン化合物を加水分解、縮合させ る際に、(B)成分を用いることが特徴である。本発明 において(B)成分を用いることにより、 冷膜の比談電 率の温度依存性とPCT後の比誘電率変化が少ないシリ カ系膜を得ることができる。本発明で使用することので きる窒素オニウム塩化合物は、(B-1)窒素含有化合 物と(B-2)アニオン性基含有化合物およびハロゲン 化合物から選ばれる少なくとも 1 種とから形成される塩 である。本発明において、アニオン性基としては、水酸 基、硝酸基、カーボネート基、カルボキシル基、スルホ ニル基、ホスホニル基、カルボニル基およびフェノキシ (1)、(2) および(3)の1種もしくは2種以上を 30 基である。(B) 成分としては、、下記一般式(4)で 表される化合物および一般式(5)で表される化合物を 挙げることができる。

 $\cdots (4)$ 

有する芳香族化合物、g個の窒素原子を有する複素環化 合物、g個の窒素原子を有する脂肪族環化合物に由来す る基である。

【0020】一般式(4)で表される化合物としては、 例えば、水酸化アンモニウム、塩化アンモニウム、臭化 アンモニウム、沃化アンモニウム、フッ化アンモニウ ム、硝酸アンモニウム、硫酸アンモニウム、硫酸水素ア ンモニウム、リン酸アンモニウム、炭酸アンモニウム、 フェノールアンモニウム、酢酸アンモニウム、アジピン 酸アンモニウム、アルギン酸アンモニウム、安息香酸ア ンモニウム、硫酸アンモニウム、クエン酸アンモニウ ム、ギ酸アンモニウム、炭酸水素アンモニウム、フタル 酸アンモニウム、サリチル酸アンモニウム、コハク酸ア ンモニウム、マレイン酸アンモニウム、プロピオン酸ア ンモニウム、ブタン酸アンモニウム、ペンタン酸アンモ 有するg価の環状カチオン性基とは、g個の窒素原子を 50 ニウム、ヘキサン酸アンモニウム、ヘプタン酸アンモニ

ウム、オクタン酸アンモニウム、ノナン酸アンモニウ ム、デカン酸アンモニウム、シュウ酸アンモニウム、メ チルマロン酸アンモニウム、セバシン酸アンモニウム、 没食子酸アンモニウム、酪酸アンモニウム、メリット酸 アンモニウム、アラキドン酸アンモニウム、シキミ酸ア ンモニウム、2-エチルヘキサン酸アンモニウム、オレ イン酸アンモニウム、ステアリン酸アンモニウム、リノ ール酸アンモニウム、リノレイン酸アンモニウム、p-アミノ安息香酸アンモニウム、p-トルエンスルホン酸 アンモニウム、ベンゼンスルホン酸アンモニウム、モノ 10 クロロ酢酸アンモニウム、ジクロロ酢酸アンモニウム、 トリクロロ酢酸アンモニウム、トリフルオロ酢酸アンモ ニウム、マロン酸アンモニウム、スルホン酸アンモニウ ム、フマル酸アンモニウム、酒石酸アンモニウム、イタ コン酸アンモニウム、メサコン酸アンモニウム、シトラ コン酸アンモニウム、リンゴ酸アンモニウム、グルタル 酸アンモニウム;水酸化メチルアンモニウム、塩化メチ ルアンモニウム、臭化メチルアンモニウム、沃化メチル アンモニウム、フッ化メチルアンモニウム、硝酸メチル アンモニウム、硫酸メチルアンモニウム、硫酸水素メチ ルアンモニウム、リン酸メチルアンモニウム、炭酸メチ ルアンモニウム、フェノールメチルアンモニウム、酢酸 メチルアンモニウム、アジビン酸メチルアンモニウム、 アルギン酸メチルアンモニウム、安息香酸メチルアンモ ニウム、硫酸メチルアンモニウム、クエン酸メチルアン モニウム、ギ酸メチルアンモニウム、炭酸水素メチルア ンモニウム、フタル酸メチルアンモニウム、サリチル酸 メチルアンモニウム、コハク酸メチルアンモニウム、マ レイン酸メチルアンモニウム、プロピオン酸メチルアン モニウム、ブタン酸メチルアンモニウム、ペンタン酸メ チルアンモニウム、ヘキサン酸メチルアンモニウム、ヘ プタン酸メチルアンモニウム、オクタン酸メチルアンモ ニウム、ノナン酸メチルアンモニウム、デカン酸メチル アンモニウム、シュウ酸メチルアンモニウム、メチルマ ロン酸メチルアンモニウム、セバシン酸メチルアンモニ ウム、没食子酸メチルアンモニウム、酪酸メチルアンモ ニウム、メリット酸メチルアンモニウム、アラキドン酸 メチルアンモニウム、シキミ酸メチルアンモニウム、2 - エチルヘキサン酸メチルアンモニウム、オレイン酸メ チルアンモニウム、ステアリン酸メチルアンモニウム、 リノール酸メチルアンモニウム、リノレイン酸メチルア ンモニウム、p-アミノ安息香酸メチルアンモニウム、 p-トルエンスルホン酸メチルアンモニウム、ベンゼン スルホン酸メチルアンモニウム、モノクロロ酢酸メチル アンモニウム、ジクロロ酢酸メチルアンモニウム、トリ クロロ酢酸メチルアンモニウム、トリフルオロ酢酸メチ ルアンモニウム、マロン酸メチルアンモニウム、スルホ ン酸メチルアンモニウム、フマル酸メチルアンモニウ ム、酒石酸メチルアンモニウム、イタコン酸メチルアン モニウム、メサコン酸メチルアンモニウム、シトラコン 50 エン酸トリメチルアンモニウム、ギ酸トリメチルアンモ

酸メチルアンモニウム、リンゴ酸メチルアンモニウム、 グルタル酸メチルアンモニウム:水酸化ジメチルアンモ ニウム、塩化ジメチルアンモニウム、臭化ジメチルアン モニウム、沃化ジメチルアンモニウム、フッ化ジメチル アンモニウム、硝酸ジメチルアンモニウム、硫酸ジメチ ルアンモニウム、硫酸水素ジメチルアンモニウム、リン 酸ジメチルアンモニウム、炭酸ジメチルアンモニウム、 フェノールジメチルアンモニウム、酢酸ジメチルアンモ ニウム、アジピン酸ジメチルアンモニウム、アルギン酸 ジメチルアンモニウム、安息香酸ジメチルアンモニウ ム、硫酸ジメチルアンモニウム、クエン酸ジメチルアン モニウム、ギ酸ジメチルアンモニウム、炭酸水素ジメチ ルアンモニウム、フタル酸ジメチルアンモニウム、サリ チル酸ジメチルアンモニウム、コハク酸ジメチルアンモ ニウム、マレイン酸ジメチルアンモニウム、プロピオン 酸ジメチルアンモニウム、ブタン酸ジメチルアンモニウ ム、ペンタン酸ジメチルアンモニウム、ヘキサン酸ジメ チルアンモニウム、ヘブタン酸ジメチルアンモニウム、 オクタン酸ジメチルアンモニウム、ノナン酸ジメチルア ンモニウム、デカン酸ジメチルアンモニウム、シュウ酸 ジメチルアンモニウム、メチルマロン酸ジメチルアンモ ニウム、セバシン酸ジメチルアンモニウム、没食子酸ジ メチルアンモニウム、酪酸ジメチルアンモニウム、メリ ット酸ジメチルアンモニウム、アラキドン酸ジメチルア ンモニウム、シキミ酸ジメチルアンモニウム、2-エチ ルヘキサン酸ジメチルアンモニウム、オレイン酸ジメチ ルアンモニウム、ステアリン酸ジメチルアンモニウム、 リノール酸ジメチルアンモニウム、リノレイン酸ジメチ ルアンモニウム、p-アミノ安息香酸ジメチルアンモニ 30 ウム、p-トルエンスルホン酸ジメチルアンモニウム、 ベンゼンスルホン酸ジメチルアンモニウム、モノクロロ 酢酸ジメチルアンモニウム、ジクロロ酢酸ジメチルアン モニウム、トリクロロ酢酸ジメチルアンモニウム、トリ フルオロ酢酸ジメチルアンモニウム、マロン酸ジメチル アンモニウム、スルホン酸ジメチルアンモニウム、フマ ル酸ジメチルアンモニウム、酒石酸ジメチルアンモニウ ム、イタコン酸ジメチルアンモニウム、メサコン酸ジメ チルアンモニウム、シトラコン酸ジメチルアンモニウ ム、リンゴ酸ジメチルアンモニウム、グルタル酸ジメチ ルアンモニウム:水酸化トリメチルアンモニウム、塩化 トリメチルアンモニウム、臭化トリメチルアンモニウ ム、沃化トリメチルアンモニウム、フッ化トリメチルア ンモニウム、硝酸トリメチルアンモニウム、硫酸トリメ チルアンモニウム、硫酸水素トリメチルアンモニウム、 リン酸トリメチルアンモニウム、炭酸トリメチルアンモ ニウム、フェノールトリメチルアンモニウム、酢酸トリ メチルアンモニウム、アジピン酸トリメチルアンモニウ ム、アルギン酸トリメチルアンモニウム、安息香酸トリ メチルアンモニウム、硫酸トリメチルアンモニウム、ク

ニウム、炭酸水素トリメチルアンモニウム、フタル酸ト リメチルアンモニウム、サリチル酸トリメチルアンモニ ウム、コハク酸トリメチルアンモニウム、マレイン酸ト リメチルアンモニウム、プロピオン酸トリメチルアンモ ニウム、ブタン酸トリメチルアンモニウム、ペンタン酸 トリメチルアンモニウム、ヘキサン酸トリメチルアンモ ニウム、ヘプタン酸トリメチルアンモニウム、オクタン 酸トリメチルアンモニウム、ノナン酸トリメチルアンモ ニウム、デカン酸トリメチルアンモニウム、シュウ酸ト リメチルアンモニウム、メチルマロン酸トリメチルアン 10 酢酸エチルアンモニウム、マロン酸エチルアンモニウ モニウム、セバシン酸トリメチルアンモニウム、没食子 酸トリメチルアンモニウム、酪酸トリメチルアンモニウ ム、メリット酸トリメチルアンモニウム、アラキドン酸 トリメチルアンモニウム、シキミ酸トリメチルアンモニ .ウム、2-エチルヘキサン酸トリメチルアンモニウム、 オレイン酸トリメチルアンモニウム、ステアリン酸トリ メチルアンモニウム、リノール酸トリメチルアンモニウ ム、リノレイン酸トリメチルアンモニウム、p-アミノ 安息香酸トリメチルアンモニウム、p~トルエンスルホ メチルアンモニウム、モノクロロ酢酸トリメチルアンモ ニウム、ジクロロ酢酸トリメチルアンモニウム、トリク ロロ酢酸トリメチルアンモニウム、トリフルオロ酢酸ト リメチルアンモニウム、マロン酸トリメチルアンモニウ ム、スルホン酸トリメチルアンモニウム、フマル酸トリ メチルアンモニウム、酒石酸トリメチルアンモニウム、 イタコン酸トリメチルアンモニウム、メサコン酸トリメ チルアンモニウム、シトラコン酸トリメチルアンモニウ ム、リンゴ酸トリメチルアンモニウム、グルタル酸トリ メチルアンモニウム;水酸化エチルアンモニウム、塩化 30 エチルアンモニウム、臭化エチルアンモニウム、沃化エ チルアンモニウム、フッ化エチルアンモニウム、硝酸エ チルアンモニウム、硫酸エチルアンモニウム、硫酸水素 エチルアンモニウム、リン酸エチルアンモニウム、炭酸 エチルアンモニウム、フェノールエチルアンモニウム、 酢酸エチルアンモニウム、アジピン酸エチルアンモニウ ム、アルギン酸エチルアンモニウム、安息香酸エチルア ンモニウム、硫酸エチルアンモニウム、クエン酸エチル アンモニウム、ギ酸エチルアンモニウム、炭酸水素エチ ルアンモニウム、フタル酸エチルアンモニウム、サリチ 40 ル酸エチルアンモニウム、コハク酸エチルアンモニウ ム、マレイン酸エチルアンモニウム、プロピオン酸エチ ルアンモニウム、ブタン酸エチルアンモニウム、ベンタ ン酸エチルアンモニウム、ヘキサン酸エチルアンモニウ ム、ヘプタン酸エチルアンモニウム、オクタン酸エチル アンモニウム、ノナン酸エチルアンモニウム、デカン酸 エチルアンモニウム、シュウ酸エチルアンモニウム、メ チルマロン酸エチルアンモニウム、セバシン酸エチルア ンモニウム、没食子酸エチルアンモニウム、酪酸エチル アンモニウム、メリット酸エチルアンモニウム、アラキ 50

ドン酸エチルアンモニウム、シキミ酸エチルアンモニウ ム、2-エチルヘキサン酸エチルアンモニウム、オレイ ン酸エチルアンモニウム、ステアリン酸エチルアンモニ ウム、リノール酸エチルアンモニウム、リノレイン酸エ チルアンモニウム、p-アミノ安息香酸エチルアンモニ ウム、pートルエンスルホン酸エチルアンモニウム、ベ ンゼンスルホン酸エチルアンモニウム、モノクロロ酢酸 エチルアンモニウム、ジクロロ酢酸エチルアンモニウ ム、トリクロロ酢酸エチルアンモニウム、トリフルオロ ム、スルホン酸エチルアンモニウム、フマル酸エチルア ンモニウム、酒石酸エチルアンモニウム、イタコン酸エ チルアンモニウム、メサコン酸エチルアンモニウム、シ トラコン酸エチルアンモニウム、リンゴ酸エチルアンモ ニウム、グルタル酸エチルアンモニウム;水酸化ジエチ ルアンモニウム、塩化ジエチルアンモニウム、臭化ジエ チルアンモニウム、沃化ジエチルアンモニウム、フッ化 ジエチルアンモニウム、硝酸ジエチルアンモニウム、硫 酸ジエチルアンモニウム、硫酸水素ジェチルアンモニウ ン酸トリメチルアンモニウム、ベンゼンスルホン酸トリ 20 ム、リン酸ジエチルアンモニウム、炭酸ジエチルアンモ ニウム、フェノールジエチルアンモニウム、酢酸ジエチ ルアンモニウム、アジピン酸ジエチルアンモニウム、ア ルギン酸ジエチルアンモニウム、安息香酸ジエチルアン モニウム、硫酸ジエチルアンモニウム、クエン酸ジエチ ルアンモニウム、ギ酸ジエチルアンモニウム、炭酸水素 ジエチルアンモニウム、フタル酸ジエチルアンモニウ ム、サリチル酸ジエチルアンモニウム、コハク酸ジエチ ルアンモニウム、マレイン酸ジエチルアンモニウム、プ ロピオン酸ジエチルアンモニウム、ブタン酸ジエチルア ンモニウム、ペンタン酸ジェチルアンモニウム、ヘキサ ン酸ジエチルアンモニウム、ヘプタン酸ジエチルアンモ ニウム、オクタン酸ジエチルアンモニウム、ノナン酸ジ エチルアンモニウム、デカン酸ジエチルアンモニウム、 シュウ酸ジエチルアンモニウム、メチルマロン酸ジエチ ルアンモニウム、セバシン酸ジェチルアンモニウム、没 食子酸ジエチルアンモニウム、酪酸ジエチルアンモニウ ム、メリット酸ジエチルアンモニウム、アラキドン酸ジ エチルアンモニウム、シキミ酸ジエチルアンモニウム、 2-エチルヘキサン酸ジェチルアンモニウム、オレイン 酸ジエチルアンモニウム、ステアリン酸ジエチルアンモ ニウム、リノール酸ジエチルアンモニウム、リノレイン 酸ジエチルアンモニウム、p-アミノ安息香酸ジエチル アンモニウム、p-トルエンスルホン酸ジェチルアンモ ニウム、ベンゼンスルホン酸ジェチルアンモニウム、モ ノクロロ酢酸ジエチルアンモニウム、ジクロロ酢酸ジェ チルアンモニウム、トリクロロ酢酸ジエチルアンモニウ ム、トリフルオロ酢酸ジェチルアンモニウム、マロン酸 ジエチルアンモニウム、スルホン酸ジエチルアンモニウ ム、フマル酸ジエチルアンモニウム、酒石酸ジエチルア ンモニウム、イタコン酸ジエチルアンモニウム、メサコ

ン酸シエチルアンモニウム、シトラコン酸ジエチルアン モニウム、リンゴ酸ジェチルアンモニウム、グルタル酸 ジエチルアンモニウム;水酸化トリエチルアンモニウ ム、塩化トリエチルアンモニウム、臭化トリエチルアン モニウム、沃化トリエチルアンモニウム、フッ化トリエ チルアンモニウム、硝酸トリエチルアンモニウム、硫酸 トリエチルアンモニウム、硫酸水素トリエチルアンモニ ウム、リン酸トリエチルアンモニウム、炭酸トリエチル アンモニウム、フェノールトリエチルアンモニウム、酢 モニウム、アルギン酸トリエチルアンモニウム、安息香 酸トリエチルアンモニウム、硫酸トリエチルアンモニウ ム、クエン酸トリエチルアンモニウム、ギ酸トリエチル アンモニウム、炭酸水素トリエチルアンモニウム、フタ ル酸トリエチルアンモニウム、サリチル酸トリエチルア ンモニウム、コハク酸トリエチルアンモニウム、マレイ ン酸トリエチルアンモニウム、プロピオン酸トリエチル アンモニウム、ブタン酸トリエチルアンモニウム、ペン タン酸トリエチルアンモニウム、ヘキサン酸トリエチル クタン酸トリエチルアンモニウム、ノナン酸トリエチル アンモニウム、デカン酸トリエチルアンモニウム、シュ ウ酸トリエチルアンモニウム、メチルマロン酸トリエチ ルアンモニウム、セバシン酸トリエチルアンモニウム、 没食子酸トリエチルアンモニウム、酪酸トリエチルアン モニウム、メリット酸トリエチルアンモニウム、アラキ ドン酸トリエチルアンモニウム、シキミ酸トリエチルア ンモニウム、2-エチルヘキサン酸トリエチルアンモニ ウム、オレイン酸トリエチルアンモニウム、ステアリン 酸トリエチルアンモニウム、リノール酸トリエチルアン 30 ロビルアンモニウム、スルホン酸トリプロビルアンモニ モニウム、リノレイン酸トリエチルアンモニウム、p-アミノ安息香酸トリエチルアンモニウム、pートルエン スルホン酸トリエチルアンモニウム、ベンゼンスルホン 酸トリエチルアンモニウム、モノクロロ酢酸トリエチル アンモニウム、ジクロロ酢酸トリエチルアンモニウム、 トリクロロ酢酸トリエチルアンモニウム、トリフルオロ 酢酸トリエチルアンモニウム、マロン酸トリエチルアン モニウム、スルホン酸トリエチルアンモニウム、フマル 酸トリエチルアンモニウム、酒石酸トリエチルアンモニ ウム、イタコン酸トリエチルアンモニウム、メサコン酸 40 ム、硫酸水素トリブチルアンモニウム、リン酸トリブチ トリエチルアンモニウム、シトラコン酸トリエチルアン モニウム、リンゴ酸トリエチルアンモニウム、グルタル 酸トリエチルアンモニウム; 水酸化トリプロピルアンモ ニウム、塩化トリプロピルアンモニウム、臭化トリプロ ピルアンモニウム、沃化トリプロピルアンモニウム、フ ッ化トリプロビルアンモニウム、硝酸トリプロビルアン モニウム、硫酸トリプロピルアンモニウム、硫酸水素ト リプロピルアンモニウム、リン酸トリプロピルアンモニ ウム、炭酸トリプロピルアンモニウム、フェノールトリ プロピルアンモニウム、酢酸トリプロピルアンモニウ

ム、アジピン酸トリプロピルアンモニウム、アルギン酸 トリプロピルアンモニウム、安息香酸トリプロピルアン モニウム、硫酸トリプロピルアンモニウム、クエン酸ト リプロピルアンモニウム、ギ酸トリプロピルアンモニウ ム、炭酸水素トリプロピルアンモニウム、フタル酸トリ プロピルアンモニウム、サリチル酸トリプロピルアンモ ニウム、コハク酸トリプロピルアンモニウム、マレイン 酸トリプロピルアンモニウム、プロピオン酸トリプロピ ルアンモニウム、ブタン酸トリプロピルアンモニウム、 酸トリエチルアンモニウム、アジビン酸トリエチルアン 10 ペンタン酸トリプロビルアンモニウム、ヘキサン酸トリ プロピルアンモニウム、ヘプタン酸トリプロピルアンモ ニウム、オクタン酸トリプロピルアンモニウム、ノナン 酸トリプロピルアンモニウム、デカン酸トリプロピルア ンモニウム、シュウ酸トリプロピルアンモニウム、メチ ルマロン酸トリプロピルアンモニウム、セバシン酸トリ プロピルアンモニウム、没食子酸トリプロピルアンモニ ウム、酪酸トリプロピルアンモニウム、メリット酸トリ プロピルアンモニウム、アラキドン酸トリプロピルアン モニウム、シキミ酸トリプロピルアンモニウム、2-エ アンモニウム、ヘプタン酸トリエチルアンモニウム、オ 20 チルヘキサン酸トリプロビルアンモニウム、オレイン酸 トリプロピルアンモニウム、ステアリン酸トリプロピル アンモニウム、リノール酸トリプロビルアンモニウム、 リノレイン酸トリプロピルアンモニウム、p-アミノ安 息香酸トリプロピルアンモニウム、p-トルエンスルホ ン酸トリプロピルアンモニウム、ベンゼンスルホン酸ト リプロピルアンモニウム、モノクロロ酢酸トリプロピル アンモニウム、ジクロロ酢酸トリプロピルアンモニウ ム、トリクロロ酢酸トリプロピルアンモニウム、トリフ ルオロ酢酸トリプロピルアンモニウム、マロン酸トリプ ウム、フマル酸トリプロピルアンモニウム、酒石酸トリ プロピルアンモニウム、イタコン酸トリプロピルアンモ ニウム、メサコン酸トリプロビルアンモニウム、シトラ コン酸トリプロピルアンモニウム、リンゴ酸トリプロピ ルアンモニウム、グルタル酸トリプロピルアンモニウ ム:水酸化トリブチルアンモニウム、塩化トリブチルア ンモニウム、臭化トリブチルアンモニウム、沃化トリブ チルアンモニウム、フッ化トリブチルアンモニウム、硝 酸トリプチルアンモニウム、硫酸トリブチルアンモニウ ルアンモニウム、炭酸トリブチルアンモニウム、フェノ ールトリブチルアンモニウム、酢酸トリブチルアンモニ ウム、アジピン酸トリブチルアンモニウム、アルギン酸 トリブチルアンモニウム、安息香酸トリブチルアンモニ ウム、硫酸トリブチルアンモニウム、クエン酸トリブチ ルアンモニウム、ギ酸トリブチルアンモニウム、炭酸水 素トリブチルアンモニウム、フタル酸トリブチルアンモ ニウム、サリチル酸トリブチルアンモニウム、コハク酸 トリブチルアンモニウム、マレイン酸トリブチルアンモ 50 ニウム、プロピオン酸トリブチルアンモニウム、ブタン

酸トリブチルアンモニウム、ペンタン酸トリブチルアン モニウム、ヘキサン酸トリブチルアンモニウム、ヘプタ ン酸トリブチルアンモニウム、オクタン酸トリブチルア ンモニウム、ノナン酸トリブチルアンモニウム、デカン 酸トリブチルアンモニウム、シュウ酸トリブチルアンモ ニウム、メチルマロン酸トリブチルアンモニウム、セバ シン酸トリブチルアンモニウム、没食子酸トリブチルア ンモニウム、酪酸トリブチルアンモニウム、メリット酸 トリプチルアンモニウム、アラキドン酸トリプチルアン ルヘキサン酸トリブチルアンモニウム、オレイン酸トリ ブチルアンモニウム、ステアリン酸トリブチルアンモニ ウム、リノール酸トリプチルアンモニウム、リノレイン 酸トリプチルアンモニウム、p-アミノ安息香酸トリブ チルアンモニウム、p-トルエンスルホン酸トリプチル アンモニウム、ベンゼンスルホン酸トリブチルアンモニ ウム、モノクロロ酢酸トリブチルアンモニウム、ジクロ 口酢酸トリブチルアンモニウム、トリクロ口酢酸トリブ チルアンモニウム、トリフルオロ酢酸トリブチルアンモ トリプチルアンモニウム、フマル酸トリプチルアンモニ ウム、酒石酸トリブチルアンモニウム、イタコン酸トリ ブチルアンモニウム、メサコン酸トリブチルアンモニウ ム、シトラコン酸トリブチルアンモニウム、リンゴ酸ト リブチルアンモニウム、グルタル酸トリブチルアンモニ ウム:水酸化テトラメチルアンモニウム、塩化テトラメ チルアンモニウム、臭化テトラメチルアンモニウム、沃 化テトラメチルアンモニウム、フッ化テトラメチルアン モニウム、硝酸テトラメチルアンモニウム、硫酸テトラ メチルアンモニウム、硫酸水素テトラメチルアンモニウ 30 モニウム、炭酸水素テトラエチルアンモニウム、フタル ム、リン酸テトラメチルアンモニウム、炭酸テトラメチ ルアンモニウム、フェノールテトラメチルアンモニウ ム、酢酸テトラメチルアンモニウム、アジビン酸テトラ メチルアンモニウム、アルギン酸テトラメチルアンモニ ウム、安息香酸テトラメチルアンモニウム、硫酸テトラ メチルアンモニウム、クエン酸テトラメチルアンモニウ ム、ギ酸テトラメチルアンモニウム、炭酸水素テトラメ チルアンモニウム、フタル酸テトラメチルアンモニウ ム、サリチル酸テトラメチルアンモニウム、コハク酸テ モニウム、プロピオン酸テトラメチルアンモニウム、ブ タン酸テトラメチルアンモニウム、ペンタン酸テトラメ チルアンモニウム、ヘキサン酸テトラメチルアンモニウ ム、ヘプタン酸テトラメチルアンモニウム、オクタン酸 テトラメチルアンモニウム、ノナン酸テトラメチルアン モニウム、デカン酸テトラメチルアンモニウム、シュウ 酸テトラメチルアンモニウム、メチルマロン酸テトラメ チルアンモニウム、セバシン酸テトラメチルアンモニウ ム、没食子酸テトラメチルアンモニウム、酪酸テトラメ

ム、アラキドン酸テトラメチルアンモニウム、シキミ酸 テトラメチルアンモニウム、2-エチルヘキサン酸テト ラメチルアンモニウム、オレイン酸テトラメチルアンモ ニウム、ステアリン酸テトラメチルアンモニウム、リノ ール酸テトラメチルアンモニウム、リノレイン酸テトラ メチルアンモニウム、p-アミノ安息香酸テトラメチル アンモニウム、p-トルエンスルホン酸テトラメチルア ンモニウム、ベンゼンスルホン酸テトラメチルアンモニ ウム、モノクロロ酢酸テトラメチルアンモニウム、ジク モニウム、シキミ酸トリプチルアンモニウム、2-エチ 10 ロロ酢酸テトラメチルアンモニウム、トリクロロ酢酸テ トラメチルアンモニウム、トリフルオロ酢酸テトラメチ ルアンモニウム、マロン酸テトラメチルアンモニウム、 スルホン酸テトラメチルアンモニウム、フマル酸テトラ メチルアンモニウム、酒石酸テトラメチルアンモニウ ム、イタコン酸テトラメチルアンモニウム、メサコン酸 テトラメチルアンモニウム、シトラコン酸テトラメチル アンモニウム、リンゴ酸テトラメチルアンモニウム、グ ルタル酸テトラメチルアンモニウム;水酸化テトラエチ ルアンモニウム、塩化テトラエチルアンモニウム、臭化 ニウム、マロン酸トリブチルアンモニウム、スルホン酸 20 テトラエチルアンモニウム、沃化テトラエチルアンモニ ウム、フッ化テトラエチルアンモニウム、硝酸テトラエ チルアンモニウム、硫酸テトラエチルアンモニウム、硫 酸水素テトラエチルアンモニウム、リン酸テトラエチル アンモニウム、炭酸テトラエチルアンモニウム、フェノ ールテトラエチルアンモニウム、酢酸テトラエチルアン モニウム、アジピン酸テトラエチルアンモニウム、アル ギン酸テトラエチルアンモニウム、安息香酸テトラエチ ルアンモニウム、硫酸テトラエチルアンモニウム、クエ ン酸テトラエチルアンモニウム、ギ酸テトラエチルアン 酸テトラエチルアンモニウム、サリチル酸テトラエチル アンモニウム、コハク酸テトラエチルアンモニウム、マ レイン酸テトラエチルアンモニウム、プロビオン酸テト ラエチルアンモニウム、ブタン酸テトラエチルアンモニ ウム、ペンタン酸テトラエチルアンモニウム、ヘキサン 酸テトラエチルアンモニウム、ヘプタン酸テトラエチル アンモニウム、オクタン酸テトラエチルアンモニウム、 ノナン酸テトラエチルアンモニウム、デカン酸テトラエ チルアンモニウム、シュウ酸テトラエチルアンモニウ トラメチルアンモニウム、マレイン酸テトラメチルアン 40 ム、メチルマロン酸テトラエチルアンモニウム、セバシ ン酸テトラエチルアンモニウム、没食子酸テトラエチル アンモニウム、酪酸テトラエチルアンモニウム、メリッ ト酸テトラエチルアンモニウム、アラキドン酸テトラエ チルアンモニウム、シキミ酸テトラエチルアンモニウ ム、2-エチルヘキサン酸テトラエチルアンモニウム、 オレイン酸テトラエチルアンモニウム、ステアリン酸テ トラエチルアンモニウム、リノール酸テトラエチルアン モニウム、リノレイン酸テトラエチルアンモニウム、p -アミノ安息香酸テトラエチルアンモニウム、p-トル チルアンモニウム、メリット酸テトラメチルアンモニウ 50 エンスルホン酸テトラエチルアンモニウム、ベンゼンス

ルホン酸テトラエチルアンモニウム、モノクロロ酢酸テ トラエチルアンモニウム、ジクロロ酢酸テトラエチルア ンモニウム、トリクロロ酢酸テトラエチルアンモニウ ム、トリフルオロ酢酸テトラエチルアンモニウム。マロ ン酸テトラエチルアンモニウム、スルホン酸テトラエチ ルアンモニウム、フマル酸テトラエチルアンモニウム、 酒石酸テトラエチルアンモニウム、イタコン酸テトラエ チルアンモニウム、メサコン酸テトラエチルアンモニウ ム、シトラコン酸テトラエチルアンモニウム、リンゴ酸 ンモニウム;水酸化テトラプロビルアンモニウム、塩化 テトラプロビルアンモニウム、臭化テトラプロビルアン モニウム、沃化テトラプロピルアンモニウム、フッ化テ トラプロビルアンモニウム、硝酸テトラプロビルアンモ ニウム、硫酸テトラプロピルアンモニウム、硫酸水素テ トラプロピルアンモニウム、リン酸テトラプロピルアン モニウム、炭酸テトラプロピルアンモニウム、フェノー ルテトラプロピルアンモニウム、酢酸テトラプロピルア ンモニウム、アジピン酸テトラプロピルアンモニウム、 ラプロピルアンモニウム、硫酸テトラプロピルアンモニ ウム、クエン酸テトラプロピルアンモニウム、ギ酸テト ラプロピルアンモニウム、炭酸水素テトラプロピルアン モニウム、フタル酸テトラプロピルアンモニウム、サリ チル酸テトラプロピルアンモニウム、コハク酸テトラブ ロビルアンモニウム、マレイン酸テトラプロビルアンモ ニウム、プロピオン酸テトラプロピルアンモニウム、ブ タン酸テトラプロピルアンモニウム、ペンタン酸テトラ プロピルアンモニウム、ヘキサン酸テトラプロピルアン クタン酸テトラプロビルアンモニウム、ノナン酸テトラ プロビルアンモニウム、デカン酸テトラプロビルアンモ ニウム、シュウ酸テトラプロピルアンモニウム、メチル マロン酸テトラプロピルアンモニウム、セバシン酸テト ラプロピルアンモニウム、没食子酸テトラプロピルアン モニウム、酪酸テトラプロビルアンモニウム、メリット 酸テトラプロピルアンモニウム、アラキドン酸テトラブ ロビルアンモニウム、シキミ酸テトラプロビルアンモニ ウム、2-エチルヘキサン酸テトラプロピルアンモニウ ム、オレイン酸テトラプロピルアンモニウム、ステアリ 40 ン酸テトラプロビルアンモニウム、リノール酸テトラブ ロビルアンモニウム、リノレイン酸テトラプロビルアン モニウム、p-アミノ安息香酸テトラプロピルアンモニ ウム、p-トルエンスルホン酸テトラプロピルアンモニ ウム、ベンゼンスルホン酸テトラプロピルアンモニウ ム、モノクロロ酢酸テトラプロビルアンモニウム、ジク ロロ酢酸テトラプロピルアンモニウム、トリクロロ酢酸 テトラプロピルアンモニウム、トリフルオロ酢酸テトラ プロピルアンモニウム、マロン酸テトラプロピルアンモ

ル酸テトラプロピルアンモニウム、酒石酸テトラプロピ ルアンモニウム、イタコン酸テトラプロピルアンモニウ ム、メサコン酸テトラプロピルアンモニウム、シトラコ ン酸テトラプロピルアンモニウム、リンゴ酸テトラプロ ビルアンモニウム、グルタル酸テトラプロビルアンモニ ウム;水酸化テトラブチルアンモニウム、塩化テトラブ チルアンモニウム、臭化テトラブチルアンモニウム、沃 化テトラブチルアンモニウム、フッ化テトラブチルアン モニウム、硝酸テトラブチルアンモニウム、硫酸テトラ テトラエチルアンモニウム、グルタル酸テトラエチルア 10 ブチルアンモニウム、硫酸水素テトラブチルアンモニウ ム、リン酸テトラブチルアンモニウム、炭酸テトラブチ ルアンモニウム、フェノールテトラブチルアンモニウ ム、酢酸テトラブチルアンモニウム、アジピン酸テトラ ブチルアンモニウム、アルギン酸テトラブチルアンモニ ウム、安息香酸テトラブチルアンモニウム、硫酸テトラ ブチルアンモニウム、クエン酸テトラブチルアンモニウ ム、ギ酸テトラブチルアンモニウム、炭酸水素テトラブ チルアンモニウム、フタル酸テトラブチルアンモニウ ム、サリチル酸テトラブチルアンモニウム、コハク酸テ アルギン酸テトラブロビルアンモニウム、安息香酸テト 20 トラブチルアンモニウム、マレイン酸テトラブチルアン モニウム、プロピオン酸テトラブチルアンモニウム、ブ タン酸テトラブチルアンモニウム、ベンタン酸テトラブ チルアンモニウム、ヘキサン酸テトラブチルアンモニウ ム、ヘプタン酸テトラブチルアンモニウム、オクタン酸 テトラブチルアンモニウム、ノナン酸テトラブチルアン モニウム、デカン酸テトラブチルアンモニウム、シュウ 酸テトラブチルアンモニウム、メチルマロン酸テトラブ チルアンモニウム、セバシン酸テトラブチルアンモニウ ム、没食子酸テトラブチルアンモニウム、酪酸テトラブ モニウム、ヘプタン酸テトラプロピルアンモニウム、オ 30 チルアンモニウム、メリット酸テトラブチルアンモニウ ム、アラキドン酸テトラブチルアンモニウム、シキミ酸 テトラブチルアンモニウム、2-エチルヘキサン酸テト ラブチルアンモニウム、オレイン酸テトラブチルアンモ ニウム、ステアリン酸テトラブチルアンモニウム。リノ ール酸テトラブチルアンモニウム、リノレイン酸テトラ ブチルアンモニウム、p-アミノ安息香酸テトラブチル アンモニウム、p-トルエンスルホン酸テトラブチルア ンモニウム、ベンゼンスルホン酸テトラブチルアンモニ ウム、モノクロロ酢酸テトラブチルアンモニウム、ジク ロロ酢酸テトラブチルアンモニウム、トリクロロ酢酸テ トラブチルアンモニウム、トリフルオロ酢酸テトラブチ ルアンモニウム、マロン酸テトラブチルアンモニウム、 スルホン酸テトラブチルアンモニウム、フマル酸テトラ ブチルアンモニウム、酒石酸テトラブチルアンモニウ ム、イタコン酸テトラブチルアンモニウム、メサコン酸 テトラブチルアンモニウム、シトラコン酸テトラブチル アンモニウム、リンゴ酸テトラブチルアンモニウム、グ ルタル酸テトラブチルアンモニウム:水酸化トリメチル ベンジルアンモニウム、塩化トリメチルベンジルアンモ ニウム、スルホン酸テトラプロピルアンモニウム、フマ 50 ニウム、臭化トリメチルベンジルアンモニウム、沃化ト

リメチルベンジルアンモニウム、フッ化トリメチルベン ジルアンモニウム、硝酸トリメチルベンジルアンモニウ ム、硫酸トリメチルベンジルアンモニウム、硫酸水素ト リメチルベンジルアンモニウム、リン酸トリメチルベン ジルアンモニウム、炭酸トリメチルベンジルアンモニウ ム、フェノールトリメチルベンジルアンモニウム、酢酸 トリメチルベンジルアンモニウム、アジピン酸トリメチ ルベンジルアンモニウム、アルギン酸トリメチルベンジ ルアンモニウム、安息香酸トリメチルベンジルアンモニ ウム、硫酸トリメチルベンジルアンモニウム、クエン酸 10 トリメチルベンジルアンモニウム、ギ酸トリメチルベン ジルアンモニウム、炭酸水素トリメチルベンジルアンモ ニウム、フタル酸トリメチルベンジルアンモニウム、サ リチル酸トリメチルベンジルアンモニウム、コハク酸ト リメチルベンジルアンモニウム、マレイン酸トリメチル ベンジルアンモニウム、プロピオン酸トリメチルベンジ ルアンモニウム、ブタン酸トリメチルベンジルアンモニ ウム、ペンタン酸トリメチルベンジルアンモニウム、ヘ キサン酸トリメチルベンジルアンモニウム、ヘプタン酸 ルベンジルアンモニウム、ノナン酸トリメチルベンジル アンモニウム、デカン酸トリメチルベンジルアンモニウ ム、シュウ酸トリメチルベンジルアンモニウム、メチル マロン酸トリメチルベンジルアンモニウム、セバシン酸 トリメチルベンジルアンモニウム、没食子酸トリメチル ベンジルアンモニウム、酪酸トリメチルベンジルアンモ ニウム、メリット酸トリメチルベンジルアンモニウム、 アラキドン酸トリメチルベンジルアンモニウム、シキミ 酸トリメチルベンジルアンモニウム、2-エチルヘキサ メチルベンジルアンモニウム、ステアリン酸トリメチル ベンジルアンモニウム、リノール酸トリメチルベンジル アンモニウム、リノレイン酸トリメチルベンジルアンモ ニウム、p-アミノ安息香酸トリメチルベンジルアンモ ニウム、p-トルエンスルホン酸トリメチルベンジルア ンモニウム、ベンゼンスルホン酸トリメチルベンジルア ンモニウム、モノクロロ酢酸トリメチルベンジルアンモ ニウム、ジクロロ酢酸トリメチルベンジルアンモニウ ム、トリクロロ酢酸トリメチルベンジルアンモニウム、 ロン酸トリメチルベンジルアンモニウム、スルホン酸ト リメチルベンジルアンモニウム、フマル酸トリメチルベ ンジルアンモニウム、酒石酸トリメチルベンジルアンモ ニウム、イタコン酸トリメチルベンジルアンモニウム、 メサコン酸トリメチルベンジルアンモニウム、シトラコ ン酸トリメチルベンジルアンモニウム、リンゴ酸トリメ チルベンジルアンモニウム、グルタル酸トリメチルベン ジルアンモニウム;

【0021】水酸化エタノールアンモニウム、塩化エタ ノールアンモニウム、臭化エタノールアンモニウム、沃 50 ノールアンモニウム、ギ酸ジエタノールアンモニウム、

化エタノールアンモニウム、フッ化エタノールアンモニ ウム、硝酸エタノールアンモニウム、硫酸エタノールア ンモニウム、硫酸水素エタノールアンモニウム、リン酸 エタノールアンモニウム、炭酸エタノールアンモニウ ム、フェノールエタノールアンモニウム、酢酸エタノー ルアンモニウム、アジビン酸エタノールアンモニウム、 アルギン酸エタノールアンモニウム、安息香酸エタノー ルアンモニウム、硫酸エタノールアンモニウム、クエン 酸エタノールアンモニウム、ギ酸エタノールアンモニウ ム、炭酸水素エタノールアンモニウム、フタル酸エタノ ールアンモニウム、サリチル酸エタノールアンモニウ ム、コハク酸エタノールアンモニウム、マレイン酸エタ ノールアンモニウム、プロピオン酸エタノールアンモニ ウム、ブタン酸エタノールアンモニウム、ペンタン酸エ タノールアンモニウム、ヘキサン酸エタノールアンモニ ウム、ヘフタン酸エタノールアンモニウム、オクタン酸 エタノールアンモニウム、ノナン酸エタノールアンモニ ウム、デカン酸エタノールアンモニウム、シュウ酸エタ ノールアンモニウム、メチルマロン酸エタノールアンモ トリメチルベンジルアンモニウム、オクタン酸トリメチ 20 ニウム、セバシン酸エタノールアンモニウム、没食子酸 エタノールアンモニウム、酪酸エタノールアンモニウ ム、メリット酸エタノールアンモニウム、アラキドン酸 エタノールアンモニウム、シキミ酸エタノールアンモニ ウム、2-エチルヘキサン酸エタノールアンモニウム、 オレイン酸エタノールアンモニウム、ステアリン酸エタ ノールアンモニウム、リノール酸エタノールアンモニウ ム、リノレイン酸エタノールアンモニウム、p-アミノ 安息香酸エタノールアンモニウム、p-トルエンスルホ ン酸エタノールアンモニウム、ベンゼンスルホン酸エタ ン酸トリメチルベンジルアンモニウム、オレイン酸トリ 30 ノールアンモニウム、モノクロロ酢酸エタノールアンモ ニウム、ジクロロ酢酸エタノールアンモニウム、トリク ロロ酢酸エタノールアンモニウム、トリフルオロ酢酸エ タノールアンモニウム、マロン酸エタノールアンモニウ ム、スルホン酸エタノールアンモニウム、フマル酸エタ ノールアンモニウム、酒石酸エタノールアンモニウム、 イタコン酸エタノールアンモニウム、メサコン酸エタノ ールアンモニウム、シトラコン酸エタノールアンモニウ ム、リンゴ酸エタノールアンモニウム、グルタル酸エタ ノールアンモニウム;水酸化ジエタノールアンモニウ トリフルオロ酢酸トリメチルベンジルアンモニウム、マ 40 ム、塩化ジエタノールアンモニウム、臭化ジエタノール アンモニウム、沃化ジエタノールアンモニウム、フッ化 ジエタノールアンモニウム、硝酸ジエタノールアンモニ ウム、硫酸ジエタノールアンモニウム、硫酸水素ジエタ ノールアンモニウム、リン酸ジエタノールアンモニウ ム、炭酸ジエタノールアンモニウム、フェノールジエタ ノールアンモニウム、酢酸ジエタノールアンモニウム アジピン酸ジェタノールアンモニウム、アルギン酸ジェ タノールアンモニウム、安息香酸ジエタノールアンモニ ウム、硫酸ジエタノールアンモニウム、クエン酸ジエタ

炭酸水素ジエタノールアンモニウム、フタル酸ジエタノ ールアンモニウム、サリチル酸ジエタノールアンモニウ ム、コハク酸ジエタノールアンモニウム、マレイン酸ジ エタノールアンモニウム、プロピオン酸ジエタノールア ンモニウム、ブタン酸ジエタノールアンモニウム、ペン タン酸ジエタノールアンモニウム、ヘキサン酸ジエタノ ールアンモニウム、ヘプタン酸ジェタノールアンモニウ ム、オクタン酸ジエタノールアンモニウム、ノナン酸ジ エタノールアンモニウム、デカン酸ジエタノールアンモ ロン酸ジエタノールアンモニウム、セバシン酸ジエタノ ールアンモニウム、没食子酸ジェタノールアンモニウ ム、酪酸ジエタノールアンモニウム、メリット酸ジエタ ノールアンモニウム、アラキドン酸ジエタノールアンモ ニウム、シキミ酸ジエタノールアンモニウム、2-エチ ルヘキサン酸ジエタノールアンモニウム、オレイン酸ジ エタノールアンモニウム、ステアリン酸ジエタノールア ンモニウム、リノール酸ジエタノールアンモニウム、リ ノレイン酸ジエタノールアンモニウム、p-アミノ安息 酸ジエタノールアンモニウム、ベンゼンスルホン酸ジェ タノールアンモニウム、モノクロロ酢酸ジェタノールア ンモニウム、ジクロロ酢酸ジエタノールアンモニウム、 トリクロロ酢酸ジエタノールアンモニウム、トリフルオ 口酢酸ジエタノールアンモニウム、マロン酸ジエタノー ルアンモニウム、スルホン酸ジェタノールアンモニウ ム、フマル酸ジエタノールアンモニウム、酒石酸ジエタ ノールアンモニウム、イタコン酸ジエタノールアンモニ ウム、メサコン酸ジエタノールアンモニウム、シトラコ ン酸ジエタノールアンモニウム、リンゴ酸ジエタノール 30 ピリジニウム、硫酸水素ピリジニウム、リン酸ピリジニ アンモニウム、グルタル酸ジエタノールアンモニウム; 水酸化トリエタノールアンモニウム、塩化トリエタノー ルアンモニウム、臭化トリエタノールアンモニウム、沃 化トリエタノールアンモニウム、フッ化トリエタノール アンモニウム、硝酸トリエタノールアンモニウム、硫酸 トリエタノールアンモニウム、硫酸水素トリエタノール アンモニウム、リン酸トリエタノールアンモニウム、炭 酸トリエタノールアンモニウム、フェノールトリエタノ ールアンモニウム、酢酸トリエタノールアンモニウム、 アジピン酸トリエタノールアンモニウム、アルギン酸ト 40 ム、ノナン酸ピリジニウム、デカン酸ピリジニウム、シ リエタノールアンモニウム、安息香酸トリエタノールア ンモニウム、硫酸トリエタノールアンモニウム、クエン 酸トリエタノールアンモニウム、ギ酸トリエタノールア ンモニウム、炭酸水素トリエタノールアンモニウム、フ タル酸トリエタノールアンモニウム、サリチル酸トリエ タノールアンモニウム、コハク酸トリエタノールアンモ ニウム、マレイン酸トリエタノールアンモニウム、プロ ピオン酸トリエタノールアンモニウム、ブタン酸トリエ タノールアンモニウム、ペンタン酸トリエタノールアン モニウム、ヘキサン酸トリエタノールアンモニウム、ヘ 50 ロロ酢酸ピリジニウム、トリクロロ酢酸ピリジニウム、

プタン酸トリエタノールアンモニウム、オクタン酸トリ エタノールアンモニウム、ノナン酸トリエタノールアン モニウム、デカン酸トリエタノールアンモニウム、シュ ウ酸トリエタノールアンモニウム、メチルマロン酸トリ エタノールアンモニウム、セバシン酸トリエタノールア ンモニウム、没食子酸トリエタノールアンモニウム、酪 酸トリエタノールアンモニウム、メリット酸トリエタノ ールアンモニウム、アラキドン酸トリエタノールアンモ ニウム、シキミ酸トリエタノールアンモニウム、2-エ ニウム、シュウ酸ジエタノールアンモニウム、メチルマ 10 チルヘキサン酸トリエタノールアンモニウム、オレイン 酸トリエタノールアンモニウム、ステアリン酸トリエタ ノールアンモニウム、リノール酸トリエタノールアンモ ニウム、リノレイン酸トリエタノールアンモニウム、p -アミノ安息香酸トリエタノールアンモニウム、p-ト ルエンスルホン酸トリエタノールアンモニウム、ベンゼ ンスルホン酸トリエタノールアンモニウム、モノクロロ 酢酸トリエタノールアンモニウム、ジクロロ酢酸トリエ タノールアンモニウム、トリクロロ酢酸トリエタノール アンモニウム、トリフルオロ酢酸トリエタノールアンモ 香酸ジエタノールアンモニウム、p-トルエンスルホン 20 ニウム、マロン酸トリエタノールアンモニウム、スルホ <sub>.</sub> ン酸トリエタノールアンモニウム、フマル酸トリエタノ ールアンモニウム、酒石酸トリエタノールアンモニウ ム、イタコン酸トリエタノールアンモニウム、メサコン 酸トリエタノールアンモニウム、シトラコン酸トリエタ ノールアンモニウム、リンゴ酸トリエタノールアンモニ ウム、グルタル酸トリエタノールアンモニウム;一般式 (5)で表される化合物としては、水酸化ピリジニウ ム、塩化ピリジニウム、臭化ピリジニウム、沃化ピリジ ニウム、フッ化ピリジニウム、硝酸ピリジニウム、硫酸 ウム、炭酸ピリジニウム、フェノールピリジニウム、酢 酸ビリジニウム、アジビン酸ビリジニウム、アルギン酸 ピリジニウム、安息香酸ピリジニウム、硫酸ピリジニウ ム、クエン酸ピリジニウム、ギ酸ピリジニウム、炭酸水 素ピリジニウム、フタル酸ピリジニウム、サリチル酸ピ リジニウム、コハク酸ピリジニウム、マレイン酸ピリジ ニウム、プロピオン酸ピリジニウム、ブタン酸ピリジニ ウム、ペンタン酸ピリジニウム、ヘキサン酸ピリジニウ ム、ヘプタン酸ピリジニウム、オクタン酸ピリジニウ ュウ酸ピリジニウム、メチルマロン酸ピリジニウム、セ バシン酸ビリジニウム、没食子酸ビリジニウム、酪酸ビ リジニウム、メリット酸ピリジニウム、アラキドン酸ピ リジニウム、シキミ酸ピリジニウム、2-エチルヘキサ ン酸ピリジニウム、オレイン酸ピリジニウム、ステアリ ン酸ピリジニウム、リノール酸ピリジニウム、リノレイ ン酸ピリジニウム、p-アミノ安息香酸ピリジニウム、 p-トルエンスルホン酸ピリジニウム、ベンゼンスルホ ン酸ピリジニウム、モノクロロ酢酸ピリジニウム、ジク

トリフルオロ酢酸ビリジニウム、マロン酸ビリジニウ ム、スルホン酸ピリジニウム、フマル酸ピリジニウム、 酒石酸ピリジニウム、イタコン酸ピリジニウム、メサコ ン酸ピリジニウム、シトラコン酸ピリジニウム、リンゴ 酸ピリジニウム、グルタル酸ピリジニウム;水酸化キノ リニウム、塩化キノリニウム、臭化キノリニウム、沃化 キノリニウム、フッ化キノリニウム、硝酸キノリニウ ム、硫酸キノリニウム、硫酸水素キノリニウム、リン酸 キノリニウム、炭酸キノリニウム、フェノールキノリニ ウム、酢酸キノリニウム、アジビン酸キノリニウム、ア 10 ム、マロン酸ピペリジニウム、スルホン酸ピペリジニウ ルギン酸キノリニウム、安息香酸キノリニウム、硫酸キ ノリニウム、クエン酸キノリニウム、ギ酸キノリニウ ム、炭酸水素キノリニウム、フタル酸キノリニウム、サ リチル酸キノリニウム、コハク酸キノリニウム、マレイ ン酸キノリニウム、プロピオン酸キノリニウム、ブタン 酸キノリニウム、ペンタン酸キノリニウム、ヘキサン酸 キノリニウム、ヘプタン酸キノリニウム、オクタン酸キ ノリニウム、ノナン酸キノリニウム、デカン酸キノリニ ウム、シュウ酸キノリニウム、メチルマロン酸キノリニ ウム、セバシン酸キノリニウム、没食子酸キノリニウ ム、酪酸キノリニウム、メリット酸キノリニウム、アラ キドン酸キノリニウム、シキミ酸キノリニウム、2-エ チルヘキサン酸キノリニウム、オレイン酸キノリニウ ム、ステアリン酸キノリニウム、リノール酸キノリニウ ム、リノレイン酸キノリニウム、p-アミノ安息香酸キ ノリニウム、pートルエンスルホン酸キノリニウム、ベ ンゼンスルホン酸キノリニウム、モノクロロ酢酸キノリ ニウム、ジクロロ酢酸キノリニウム、トリクロロ酢酸キ ノリニウム、トリフルオロ酢酸キノリニウム、マロン酸 キノリニウム、スルホン酸キノリニウム、フマル酸キノ リニウム、酒石酸キノリニウム、イタコン酸キノリニウ ム、メサコン酸キノリニウム、シトラコン酸キノリニウ ム、リンゴ酸キノリニウム、グルタル酸キノリニウム; 水酸化ピペリジニウム、塩化ピペリジニウム、臭化ピペ リジニウム、沃化ピペリジニウム、フッ化ピペリジニウ ム、硝酸ピペリジニウム、硫酸ピペリジニウム、硫酸水 素ピペリジニウム、リン酸ピペリジニウム、炭酸ピペリ ジニウム、フェノールピペリジニウム、酢酸ピペリジニ ウム、アジピン酸ピペリジニウム、アルギン酸ピペリジ ニウム、安息香酸ピペリジニウム、硫酸ピペリジニウ ム、クエン酸ピペリジニウム、ギ酸ピペリジニウム、炭 酸水素ピペリジニウム、フタル酸ピペリジニウム、サリ チル酸ピペリジニウム、コハク酸ピペリジニウム、マレ イン酸ピペリジニウム、プロピオン酸ピペリジニウム、 ブタン酸ピペリジニウム、ペンタン酸ピペリジニウム、 ヘキサン酸ピペリジニウム、ヘブタン酸ピペリジニウ ム、オクタン酸ピペリジニウム、ノナン酸ピペリジニウ ム、デカン酸ピペリジニウム、シュウ酸ピペリジニウ ム、メチルマロン酸ピペリジニウム、セバシン酸ピペリ

ム、メリット酸ピペリジニウム、アラキドン酸ピペリジ ニウム、シキミ酸ピペリジニウム、2-エチルヘキサン 酸ピペリジニウム、オレイン酸ピペリジニウム、ステア リン酸ピペリジニウム、リノール酸ピペリジニウム、リ ノレイン酸ピペリジニウム、p-アミノ安息香酸ピペリ ジニウム、p-トルエンスルホン酸ピペリジニウム、ベ ンゼンスルホン酸ピペリジニウム、モノクロロ酢酸ピペ リジニウム、ジクロロ酢酸ピペリジニウム、トリクロロ 酢酸ピペリジニウム、トリフルオロ酢酸ピペリジニウ ム、フマル酸ピベリジニウム、酒石酸ピペリジニウム、 イタコン酸ピペリジニウム、メサコン酸ピペリジニウ ム、シトラコン酸ピペリジニウム、リンゴ酸ピペリジニ ウム、グルタル酸ピペリジニウム;水酸化ピペラジニウ ム、塩化ピペラジニウム、臭化ピペラジニウム、沃化ビ ペラジニウム、フッ化ピペラジニウム、硝酸ピペラジニ ウム、硫酸ピペラジニウム、硫酸水素ピペラジニウム、 リン酸ピペラジニウム、炭酸ピペラジニウム、フェノー ルピペラジニウム、酢酸ピペラジニウム、アジピン酸ピ 20 ペラジニウム、アルギン酸ピペラジニウム、安息香酸ピ ペラジニウム、硫酸ピペラジニウム、クエン酸ピペラジ ニウム、ギ酸ピペラジニウム、炭酸水素ピペラジニウ ム、フタル酸ピペラジニウム、サリチル酸ピペラジニウ ム、コハク酸ピペラジニウム、マレイン酸ピペラジニウ ム、プロピオン酸ピペラジニウム、ブタン酸ピペラジニ ウム、ペンタン酸ピペラジニウム、ヘキサン酸ピペラジ ニウム、ヘプタン酸ピペラジニウム、オクタン酸ピペラ ジニウム、ノナン酸ビベラジニウム、デカン酸ビベラジ ニウム、シュウ酸ピペラジニウム、メチルマロン酸ピペ 30 ラジニウム、セバシン酸ピペラジニウム、没食子酸ピペ ラジニウム、酪酸ピペラジニウム、メリット酸ピペラジ ニウム、アラキドン酸ピペラジニウム、シキミ酸ピペラ ジニウム、2-エチルヘキサン酸ピペラジニウム、オレ イン酸ピペラジニウム、ステアリン酸ピペラジニウム、 リノール酸ピペラジニウム、リノレイン酸ピペラジニウ ム、p-アミノ安息香酸ピペラジニウム、p-トルエン スルホン酸ピペラジニウム、ベンゼンスルホン酸ピペラ ジニウム、モノクロロ酢酸ピペラジニウム、ジクロロ酢 酸ピペラジニウム、トリクロロ酢酸ピペラジニウム、ト 40 リフルオロ酢酸ピペラジニウム、マロン酸ピペラジニウ ム、スルホン酸ピペラジニウム、フマル酸ピペラジニウ ム、酒石酸ピペラジニウム、イタコン酸ピペラジニウ ム、メサコン酸ピペラジニウム、シトラコン酸ピペラジ ニウム、リンゴ酸ビペラジニウム、グルタル酸ビペラジ ニウム:ジアザビシクロオクタン塩酸塩、ジアザビシク ロオクタン臭酸塩、ジアザビシクロオクタン硝酸塩、ジ アザビシクロオクタン硫酸塩、ジアザビシクロオクタン 硫酸水素塩、ジアザビシクロオクタン炭酸塩、ジアザビ シクロオクタン炭酸水素塩、ジアザビシクロオクタン酢 ジニウム、没食子酸ピペリジニウム、酪酸ピペリジニウ 50 酸塩、ジアザビシクロオクタンマレイン酸塩、ジアザビ (16)

シクロオクタンフタル酸塩、ジアザビシクロオクタンシ ュウ酸塩、ジアザビシクロオクタンイタコン酸塩、ジア ザビシクロオクタンマロン酸塩、ジアザビシクロオクタ ンギ酸塩、ジアザビシクロオクタン酪酸塩、ジアザビシ クロオクタンリンゴ酸塩、ジアザビシクロノナン塩酸 塩、ジアザビシクロノナン臭酸塩、ジアザビシクロノナ ン硝酸塩、ジアザビシクロノナン硫酸塩、ジアザビシク ロノナン硫酸水素塩、ジアザビシクロノナン炭酸塩、ジ アザビシクロノナン炭酸水素塩、ジアザビシクロノナン 酢酸塩、ジアザビシクロノナンマレイン酸塩、ジアザビ 10 シクロノナンフタル酸塩、ジアザビシクロノナンシュウ 酸塩、ジアザビシクロノナンイタコン酸塩、ジアザビシ クロノナンマロン酸塩、ジアザビシクロノナンギ酸塩、 シアザビシクロノナン酪酸塩、ジアザビシクロノナンリ ンゴ酸塩、ジアザビシクロウンデセン塩酸塩、ジアザビ シクロウンデセン臭酸塩、ジアザビシクロウンデセン硝 酸塩、ジアザビシクロウンデセン硫酸塩、ジアザビシク ロウンデセン硫酸水素塩、ジアザビシクロウンデセン炭 酸塩、ジアザビシクロウンデセン炭酸水素塩、ジアザビ シクロウンデセン酢酸塩、ジアザビシクロウンデセンマ 20 レイン酸塩、ジアザビシクロウンデセンフタル酸塩、ジ アザビシクロウンデセンシュウ酸塩、ジアザビシクロウ ンデセンイタコン酸塩、ジアザビシクロウンデセンマロ ン酸塩、ジアザビシクロウンデセンギ酸塩、ジアザビシ クロウンデセン酪酸塩、ジアザビシクロウンデセンリン ゴ酸塩などを挙げることができる。これらの中で、水酸 化窒素オニウム塩化合物とカルボン酸窒素オニウム塩化 合物を好ましい例として挙げることができ、水酸化アン モニウム化合物とカルボン酸アンモニウム塩化合物が特 に好ましい。これらの(B)成分は、1種あるいは2種 以上を同時に使用してもよい。

【0022】上記(B)成分の使用量は、化合物(1) ~ (3) 中のR'O-基, R'O-基, R'O-基およ びR'O-基で表される基の総量1モルに対して、通 常、0.00001~1モル、好ましくは0.0000 5~0.5モルである。(B)成分の使用量が上記範囲 内であれば、反応中のポリマーの析出やゲル化の恐れが 少ない。なお、上記(A)成分を加水分解、縮合させる 際に、(A)成分1モル当たり0.5~150モルの (C) 水を用いることが好ましく、0.5~130モル 40 の水を加えることが特に好ましい。添加する水の量が 0. 5モル未満であると塗膜の耐クラック性が劣る場合 があり、150モルを越えると加水分解および縮合反応 中のポリマーの析出やゲル化が生じる場合がある。本発 明の(A)成分の加水分解時に使用する(D)沸点10 0℃以下のアルコールとしては、例えばメタノール、エ タノール、n-プロパノール、イソプロパノールを挙げ ることができる。沸点100℃以下のアルコールの使用 量は、(A)成分1モルに対して通常3~100モル、

する際の濃度としては $0.5\sim10\%$  (完全加水分解縮合物換算) であり、より好ましくは $1\sim8\%$ である。また、この際の反応温度としては、通常、 $0\sim100\%$  好ましくは $15\sim90\%$ である。

【0023】本発明の膜形成用組成物の具体的な製造方法としては、例えば、(D)成分と(E)成分中化合物(1)~(3)を混合して、水を連続的または断続的に添加して、加水分解し、縮合すればよく、特に限定されないが、下記1)~11)の方法などを挙げることができる。

- 1) (A) 成分を構成する化合物(1)~(3)、
- (B)成分、(C)成分および(C)成分からなる混合物に、所定量の水を加えて、加水分解・縮合反応を行う方法。
- 2) (A) 成分を構成する化合物 (1) ~ (3)、
- (B)成分、(D)成分からなる混合物に、所定量の水 を連続的あるいは断続的に添加して、加水分解、縮合反 応を行う方法。
- 3) (A) 成分を構成する化合物(1)~(3)、
- (D) 成分からなる混合物に、所定量の水および(B) 成分を加えて、加水分解・縮合反応を行う方法。
  - 4) (A) 成分を構成する化合物(1)~(3)、
  - (D)成分からなる混合物に、所定量の水および(B) 成分を連続的あるいは断続的に添加して、加水分解、縮 合反応を行う方法。
  - 5) (D) 成分、水および(B) 成分からなる混合物 に、所定量の(A) 成分を構成する化合物(1)~
  - (3)を加えて、加水分解・縮合反応を行う方法。
- 6) (D) 成分、水および(B) 成分からなる混合物 に、所定量の(A) 成分を構成する化合物(1)~
- (3)を連続的あるいは断続的に添加して、加水分解・ 縮合反応を行う方法。
- 7) (D) 成分、水および(B) 成分からなる混合物 に、所定量の(A) 成分を構成する化合物(1)~
- (3)を加えて、加水分解・縮合反応を行い、pH調整 剤を添加する方法。
- 8) (D) 成分、水および(B) 成分からなる混合物 に、所定量の(A) 成分を構成する化合物(1)~
- (3)を加えて、加水分解・縮合反応を行い、溶液の一 定濃度に濃縮した後pH調整剤を添加する方法。
- 9)上記1)~8)の方法で得られた溶液を、有機溶剤で抽出する方法。
- 10)上記1)~8)の方法で得られた溶液を、有機溶剤で置換する方法。
- 11)上記1)~8)の方法で得られた溶液を、有機溶剤で抽出した後、別な有機溶剤で置換する方法。 このようにして得られる(A)成分の加水分解縮合物の

るととができる。沸点100℃以下のアルコールの使用 量は、(A)成分1モルに対して通常3~100モル、 よる慣性半径で、好ましくは4~50nm、さらに好ま 好ましくは5~80モルである。(A)成分を加水分解 50 しくは6~40nm、特に好ましくは7~30nmであ

る。加水分解縮合物の慣性半径が4~50 n mである と、得られるシリカ系膜の比誘電率、弾性率および膜の 均一性に特に優れるものとできる。また、このようにし て得られる(A)加水分解縮合物は、粒子状の形態をと っていないことにより、基板状への塗布性が優れるとい う特徴を有している。粒子状の形態をとっていないこと は、例えば透過型電子顕微鏡観察(TEM)により確認

【0024】さらに、(A)成分のを加水分解、縮合し た後、膜形成用組成物のpHを7以下に調整することが 10 好ましい。pHを調整する方法としては、

①p H調整剤を添加する方法、

②常圧または減圧下で、組成物中より(B)成分を留去 する方法、

◎窒素、アルゴンなどのガスをバブリングすることによ り、組成物中から(B)成分を除去する方法:

④イオン交換樹脂により、組成物中から(B)成分を除 く方法、

り抽出や洗浄によって(B)成分を系外に除去する方

などが挙げられる。これらの方法は、それぞれ、組み合 わせて用いてもよい。

【0025】ととで、上記pH調整剤としては、無機酸 や有機酸が挙げられる。無機酸としては、例えば、塩 酸、硝酸、硫酸、フッ酸、リン酸、ホウ酸、シュウ酸な どを挙げることができる。また、有機酸としては、例え ば、酢酸、プロビオン酸、ブタン酸、ペンタン酸、ヘキ サン酸、ヘプタン酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン 酸、シュウ酸、マレイン酸、メチルマロン酸、アジピン ドン酸、シキミ酸、2-エチルヘキサン酸、オレイン 酸、ステアリン酸、リノール酸、リノレイン酸、サリチ ル酸、安息香酸、p-アミノ安息香酸、p-トルエンス ルホン酸、ベンゼンスルホン酸、モノクロロ酢酸、ジク ロロ酢酸、トリクロロ酢酸、トリフルオロ酢酸、ギ酸、 マロン酸、スルホン酸、フタル酸、フマル酸、クエン 酸、酒石酸、コハク酸、フマル酸、イタコン酸、メサコ ン酸、シトラコン酸、リンゴ酸、グルタル酸の加水分解 物、無水マレイン酸の加水分解物、無水フタル酸の加水 分解物などを挙げることができる。これら化合物は、1 種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

【0026】上記pH調整剤による組成物のpHは、7 以下、好ましくは1~6に調整される。とのように、加 水分解縮合物の慣性半径を4~50 n m となしたのち、 上記pH調整剤により上記範囲内にpHを調整すること により、得られる組成物の貯蔵安定性が向上するという 効果が得られる。pH調整剤の使用量は、組成物のpH が上記範囲内となる量であり、その使用量は、適宜選択

機溶媒としては、アルコール系溶媒、ケトン系溶媒、ア ミド系溶媒、エステル系溶媒および非プロトン系溶媒の 群から選ばれた少なくとも1種が挙げられる。ととで、 アルコール系溶媒としては、メタノール、エタノール、 n-プロパノール、i-プロパノール、n-ブタノー ル、i-ブタノール、sec-ブタノール、t-ブタノ ール、n-ペンタノール、i-ペンタノール、2-メチ ルプタノール、sec-ペンタノール、t-ペンタノー ル、3-メトキシブタノール、n-ヘキサノール、2-メチルペンタノール、Sec‐ヘキサノール、2‐エチ ルプタノール、Sec-ヘプタノール、ヘプタノールー 3、n-オクタノール、2-エチルヘキサノール、se c-オクタノール、n-ノニルアルコール、2,6~ジ メチルヘプタノールー4、n-デカノール、sec-ウ ンデシルアルコール、トリメチルノニルアルコール。s ec-テトラデシルアルコール、sec-ヘプタデシル アルコール、フェノール、シクロヘキサノール、メチル シクロヘキサノール、3,3,5-トリメチルシクロへ キサノール、ベンジルアルコール、ジアセトンアルコー 20 ルなどのモノアルコール系溶媒:

【0028】エチレングリコール、1,2-プロピレン グリコール、1,3-ブチレングリコール、ペンタンジ オール-2,4、2-メチルペンタンジオール-2. 4、ヘキサンジオールー2、5、ヘプタンジオールー 2, 4、2-エチルヘキサンジオール-1, 3、ジエチ レングリコール、ジプロピレングリコール、トリエチレ ングリコール、トリプロピレングリコールなどの多価ア ルコール系溶媒:エチレングリコールモノメチルエーテ ル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレン 酸、セパシン酸、没食子酸、酪酸、メリット酸、アラキ 30 グリコールモノプロピルエーテル、エチレングリコール モノブチルエーテル、エチレングリコールモノヘキシル エーテル、エチレングリコールモノフェニルエーテル、 エチレングリコールモノ-2-エチルブチルエーテル、 ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレン グリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコール モノプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノブチ ルエーテル、ジエチレングリコールモノヘキシルエーテ ル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピ レングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコ 40 ールモノプロピルエーテル、プロピレングリコールモノ ブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエ ーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、 ジプロピレングリコールモノプロピルエーテルなどの多 価アルコール部分エーテル系溶媒;などを挙げることが できる。これらのアルコール系溶媒は、1種あるいは2 種以上を同時に使用してもよい。

【0029】ケトン系溶媒としては、アセトン、メチル エチルケトン、メチルーnープロピルケトン、メチルー n-ブチルケトン、ジエチルケトン、メチル-i-ブチ 【0027】上記の製造方法9)~11)で使用する有 50 ルケトン、メチルーnーペンチルケトン、エチルーnー

ブチルケトン、メチルーn-ヘキシルケトン、ジーi-ブチルケトン、トリメチルノナノン、シクロヘキサノ ン、2-ヘキサノン、メチルシクロヘキサノン、2,4 ーペンタンジオン、アセトニルアセトン、アセトフェノ ン、フェンチョンなどのほか、アセチルアセトン、2. 4-ヘキサンジオン、2、4-ヘプタンジオン、3、5 -ヘプタンジオン、2、4 −オクタンジオン、3、5 − オクタンジオン、2、4-ノナンジオン、3、5-ノナ ンジオン、5-メチル-2,4-ヘキサンジオン、2, 2, 6, 6-テトラメチル-3, 5-ヘプタンジオン 1, 1, 1, 5, 5, 5-ヘキサフルオロー2, 4-ヘ フタンジオンなどのβージケトン類などが挙げられる。 これらのケトン系溶媒は、1種あるいは2種以上を同時 に使用してもよい。

【0030】アミド系溶媒としては、ホルムアミド、N -メチルホルムアミド、N、N - ジメチルホルムアミ ド、N-エチルホルムアミド、N, N-ジエチルホルム アミド、アセトアミド、N-メチルアセトアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N-エチルアセトアミド、 アミド、N-メチルピロリドン、N-ホルミルモルホリ ン、N-ホルミルピペリジン、N-ホルミルピロリジ ン、N-アセチルモルホリン、N-アセチルピペリジ ン、N-アセチルピロリジンなどが挙げられる。これら アミド系溶媒は、1種あるいは2種以上を同時に使用し

【0031】エステル系溶媒としては、ジエチルカーボ ネート、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、炭酸ジエチ ル、酢酸メチル、酢酸エチル、アーブチロラクトン、ア - パレロラクトン、酢酸n - プロピル、酢酸i - プロピ 30 - ジメチルテトラヒドロ-2 (1 H) - ピリミジノンな ル、酢酸nープチル、酢酸iーブチル、酢酸secーブ チル、酢酸 n - ペンチル、酢酸 s e c - ペンチル、酢酸 3-メトキシブチル、酢酸メチルペンチル、酢酸2-エ\* R''O (CHCH, CH, O) , R''

(R11およびR11は、それぞれ独立して水素原子、炭素 数1~4のアルキル基またはСH,С〇-から選ばれる 1価の有機基を示し、gは1~2の整数を表す。) 以上の有機溶媒は、1種あるいは2種以上を混合して使 用することができる。

## 【0033】その他の添加剤

本発明で得られる膜形成用組成物には、さらにコロイド 状シリカ、コロイド状アルミナ、有機ポリマー、界面活 性剤、シランカップリング剤、ラジカル発生剤、トリア ゼン化合物などの成分を添加してもよい。コロイド状シ リカとは、例えば、高純度の無水ケイ酸を前記親水性有 機溶媒に分散した分散液であり、通常、平均粒径が5~ 30mμ、好ましくは10~20mμ、固形分濃度が1 0~40重量%程度のものである。とのような、コロイ ド状シリカとしては、例えば、日産化学工業(株)製、

\* チルブチル、酢酸2-エチルヘキシル、酢酸ベンジル、 酢酸シクロヘキシル、酢酸メチルシクロヘキシル、酢酸 n-ノニル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、酢 酸エチレングリコールモノメチルエーテル、酢酸エチレ ングリコールモノエチルエーテル、酢酸ジエチレングリ コールモノメチルエーテル、酢酸ジエチレングリコール モノエチルエーテル、酢酸ジエチレングリコールモノー n-ブチルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノメ チルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノエチルエ 10 ーテル、酢酸プロピレングリコールモノプロピルエーテ ル、酢酸プロピレングリコールモノブチルエーテル、酢 酸ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、酢酸ジ プロピレングリコールモノエチルエーテル、ジ酢酸グリ コール、酢酸メトキシトリグリコール、プロピオン酸エ チル、プロピオン酸 n - ブチル、プロピオン酸 i - アミ ル、シュウ酸ジエチル、シュウ酸ジ-n-ブチル、乳酸 メチル、乳酸エチル、乳酸 n - ブチル、乳酸 n - アミ ル、マロン酸ジエチル、フタル酸ジメチル、フタル酸ジ エチルなどが挙げられる。これらエステル系溶媒は、1 N. N-ジエチルアセトアミド、N-メチルプロピオン 20 種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。非プロト ン系溶媒としては、アセトニトリル、ジメチルスルホキ シド、N, N, N´, N´ーテトラエチルスルファミ ド、ヘキサメチルリン酸トリアミド、N-メチルモルホ ロン、N-メチルヒロール、N-エチルヒロール、N-メチルーΔ3 ーピロリン、N-メチルピペリジン、N-エチルピペリジン、N、N-ジメチルピペラジン、N-メチルイミダゾール、N-メチル-4-ピペリドン、N -メチル-2-ピペリドン、N-メチル-2-ピロリド ン、1、3ージメチルー2ーイミダゾリジノン、1、3 どを挙げることができる。

> 【0032】とれらの有機溶剤の中で、特に下記一般式 (6)で表される溶剤を使用することが好ましい。  $\cdots$  (6)

ル;触媒化成工業(株)製、オスカルなどが挙げられ る。コロイド状アルミナとしては、日産化学工業(株) 製のアルミナゾル520、同100、同200;川研フ ァインケミカル(株)製のアルミナクリアーゾル、アル ミナゾル10、同132などが挙げられる。有機ポリマ 40 ーとしては、例えば、糖鎖構造を有する化合物、ビニル アミド系重合体、(メタ) アクリル系重合体、芳香族ビ ニル化合物、デンドリマー、ポリイミド、ポリアミック 酸、ポリアリーレン、ポリアミド、ポリキノキサリン、 ポリオキサジアゾール、フッ索系重合体、ポリアルキレ ンオキサイド構造を有する化合物などを挙げることがで きる。

【0034】ポリアルキレンオキサイド構造を有する化 合物としては、ポリメチレンオキサイド構造、ポリエチ レンオキサイド構造、ポリプロピレンオキサイド構造、 メタノールシリカゾルおよびイソプロパノールシリカゾ 50 ポリテトラメチレンオキサイド構造、ポリブチレンオキ

シド構造などが挙げられる。具体的には、ポリオキシメ チレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキル エーテル、ポリオキシエテチレンアルキルフェニルエー テル、ポリオキシエチレンステロールエーテル、ポリオ キシエチレンラノリン誘導体、アルキルフェノールホル マリン縮合物の酸化エチレン誘導体、ポリオキシエチレ ンポリオキシブロビレンブロックコポリマー、ポリオキ シエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテルなど のエーテル型化合物、ポリオキシエチレングリセリン脂 ステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステ ル、ポリオキシエチレン脂肪酸アルカノールアミド硫酸 塩などのエーテルエステル型化合物、ポリエチレングリ コール脂肪酸エステル、エチレングリコール脂肪酸エス テル、脂肪酸モノグリセリド、ポリグリセリン脂肪酸エ

-(X) j - (Y) k - $-(X) j - (Y) k - (X) 1_{-}$ 

げられる。

(式中、Xは-CH、CH、O-で表される基を、Yは-CH, CH (CH,) O-で表される基を示し、jは1~ 90、kは10~99、1は0~90の数を示す) これらの中で、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、 ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロックコポ リマー、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアル キルエーテル、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エ 30 ステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステ ル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル、 などのエーテル型化合物をより好ましい例として挙げる ととができる。とれらは1種あるいは2種以上を同時に 使用しても良い。

ステル、ソルビタン脂肪酸エステル、プロビレングリコ

ール脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステルなどのエー

テルエステル型化合物などを挙げることができる。ポリ

オキシチレンポリオキシプロピレンブロックコポリマー

としては下記のようなブロック構造を有する化合物が挙 20

【0035】界面活性剤としては、例えば、ノニオン系 界面活性剤、アニオン系界面活性剤、カチオン系界面活 性剤、両性界面活性剤などが挙げられ、さらには、ファ 素系界面活性剤、シリコーン系界面活性剤、ポリアルキ レンオキシド系界面活性剤、ポリ (メタ) アクリレート 40 系界面活性剤などを挙げることができ、好ましくはファ 素系界面活性剤、シリコーン系界面活性剤を挙げること ができる。

【0036】フッ素系界面活性剤としては、例えば1, 1, 2, 2-テトラフロロオクチル(1, 1, 2, 2-テトラフロロプロピル) エーテル、1,1,2,2-テ トラフロロオクチルヘキシルエーテル、オクタエチレン グリコールジ(1,1,2,2~テトラフロロブチル) エーテル、ヘキサエチレングリコール(1,1,2,

プロピレングリコールジ(1,1,2,2-テトラフロ ロブチル)エーテル、ヘキサプロピレングリコールジ (1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフロロベンチル) エ ーテル、パーフロロドデシルスルホン酸ナトリウム 1, 1, 2, 2, 8, 8, 9, 9, 10, 10-デカフ ロロドデカン、1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフロロ デカン、N-[3-(パーフルオロオクタンスルホンア ミド)プロピル]-N, N '-ジメチル-N-カルボキ シメチレンアンモニウムベタイン、パーフルオロアルキ 肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エ 10 ルスルホンアミドプロビルトリメチルアンモニウム塩、 パーフルオロアルキル-N-エチルスルホニルグリシン 塩、リン酸ビス(N-パーフルオロオクチルスルホニル -N-エチルアミノエチル)、モノパーフルオロアルキ ルエチルリン酸エステル等の末端、主鎖および側鎖の少 なくとも何れかの部位にフルオロアルキルまたはフルオ ロアルキレン基を有する化合物からなるフッ素系界面活 性剤を挙げることができる。また、市販品としてはメガ ファックF142D、同F172、同F173、同F1 83 (以上、大日本インキ化学工業(株)製)、エフト ップEF301、同303、同352 (新秋田化成 (株) 製)、フロラードFC-430、同FC-431 (住友スリーエム(株)製)、アサヒガードAG71 O、サーフロンS-382、同SC-101、同SC-102、同SC-103、同SC-104、同SC-1 05、同SC-106(旭硝子(株)製)、BM-10 00、BM-1100(裕商(株)製)、NBX-15 ((株)ネオス)などの名称で市販されているフッ素系 界面活性剤を挙げることができる。これらの中でも、上 記メガファックF172,BM-1000,BM-11 00、NBX-15が特に好ましい。シリコーン系界面 活性剤としては、例えばSH7PA、SH21PA、S H30PA、ST94PA (いずれも東レ・ダウコーニ ング・シリコーン(株)製などを用いることが出来る。 これらの中でも、上記SH28PA、SH30PAが特 に好ましい。

> 【0037】界面活性剤の使用量は、(A)成分(完全 加水分解縮合物)に対して通常0.0001~10重量 部である。とれらは1種あるいは2種以上を同時に使用 しても良い。

【0038】シランカップリング剤としては、例えば3 グリシジロキシプロピルトリメトキシシラン、3-ア ミノグリシジロキシプロピルトリエトキシシラン、3-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、3-グリ シジロキシプロピルメチルジメトキシシラン、1-メタ クリロキシブロビルメチルジメトキシシラン、3-アミ ノプロピルトリメトキシシラン、3-アミノプロピルト リエトキシシラン、2-アミノプロピルトリメトキシシ ラン、2-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-(2-アミノエチル) -3-アミノプロピルトリメトキ 2, 3, 3- $^+$ 0,  $^-$ 0,  $^-$ 1,  $^-$ 2,  $^-$ 2,  $^-$ 3,  $^-$ 3,  $^-$ 4,  $^-$ 4,  $^-$ 3,  $^-$ 4,  $^-$ 7,  $^-$ 7,  $^-$ 8,  $^-$ 9,

ピルメチルジメトキシシラン、3-ウレイドプロピルト. リメトキシシラン、3-ウレイドプロピルトリエトキシ シラン、N-エトキシカルボニル-3-アミノプロビル トリメトキシシラン、N-エトキシカルボニル-3-ア ミノプロピルトリエトキシシラン、N-トリエトキシシ リルプロピルトリエチレントリアミン、N-トリエトキ シシリルプロピルトリエチレントリアミン、10-トリ メトキシシリル-1, 4, 7-トリアザデカン、10-トリエトキシシリルー1, 4, 7-トリアザデカン、9 ト、9-トリエトキシシリル-3,6-ジアザノニルア セテート、N-ベンジル-3-アミノプロピルトリメト キシシラン、N-ベンジル-3-アミノプロビルトリエ トキシシラン、N-フェニル-3-アミノプロピルトリ メトキシシラン、N-フェニル-3-アミノプロピルト リエトキシシラン、N-ビス (オキシエチレン) -3-アミノプロピルトリメトキシシラン、 N-ビス (オキシ エチレン) -3-アミノプロピルトリエトキシシランな どが挙げられる。これらは1種あるいは2種以上を同時 に使用しても良い。

【0039】ラジカル発生剤としては、例えばイソブチ リルパーオキサイド、α、α' ビス (ネオデカノイルバ ーオキシ)ジイソプロピルベンゼン、クミルパーオキシ ネオデカノエート、ジーnプロピルパーオキシジカーボ ネート、ジイソプロピルパーオキシジカーボネート、 1, 1, 3, 3-テトラメチルブチルバーオキシネオデ カノエート、ビス(4-t-ブチルシクロヘキシル)パ ーオキシジカーボネート、1-シクロヘキシル-1-メ チルエチルパーオキシネオデカノエート、ジー2-エト ヘキシルパーオキシ) ジカーボネート、 t ーヘキシルバ ーオキシネオデカノエート、ジメトキブチルバーオキシ ジカーボネート、ジ (3-メチル-3-メトキシブチル パーオキシ) ジカーボネート、t - ブチルパーオキシネ オデカノエート、2、4-ジクロロベンゾイルパーオギ サイド、t‐ヘキシルパーオキシピバレート、t‐ブチ ルパーオキシピバレート、3,5,5-トリメチルヘキ サノイルパーオキサイド、オクタノイルパーオキサイ ド、ラウロイルパーオキサイド、ステアロイルパーオキ シ2-エチルヘキサノエート、スクシニックパーオキサ イド、2,5-ジメチル-2,5-ジ(2-エチルヘキ サノイルパーオキシ) ヘキサン、1-シクロヘキシルー 1-メチルエチルパーオキシ2-エチルヘキサノエー ト、t-ヘキシルパーオキシ2-エチルヘキサノエー ト、t-ブチルパーオキシ2-エチルヘキサノエート、 m-トルオイルアンドベンゾイルパーオキサイド ベン ゾイルパーオキサイド、t-ブチルパーオキシイソブチ レート、ジーt-ブチルパーオキシ-2-メチルシクロ ヘキサン、1, 1-ピス(t-ヘキシルパーオキシ) - 50

3. 3. 5 - トリメチルシクロヘキサン、1, 1 - ビス (t-ヘキシルパーオキシ)シクロヘキサン、1,1-ビス(t-ブチルバーオキシ)-3,3,5-トリメチ ルシクロヘキサン、1,1-ビス(t-ブチルパーオキ シ)シクロヘキサン、2,2-ビス(4,4-ジ-t-ブチルパーオキシシクロヘキシル)プロパン、1,1-ビス(t-ブチルパーオキシ)シクロデカン、t-ヘキ シルパーオキシイソプロピルモノカーボネート、t-ブ チルパーオキシマレイン酸、t-ブチルパーオキシー ートリメトキシシリル-3, 6-ジアザノニルアセテー 10 3, 3, 5-トリメチルヘキサノエート、t-ブチルバ ーオキシラウレート、2、5-ジメチル-2、5-ジ (m-トルオイルバーオキシ) ヘキサン、t-ブチルバ ーオキシイソプロピルモノカーボネート。 t - ブチルバ ーオキシ2 - エチルヘキシルモノカーボネート、t-ヘ キシルパーオキシベンゾエート、2,5-ジメチルー 2.5-ジ(ベンゾイルパーオキシ)へキサン、t-ブ チルパーオキシアセテート、2,2-ビス(t-ブチル パーオキシ) ブタン、t-ブチルパーオキシベンゾエー ト、n-ブチル-4, 4-ビス(t-ブチルパーオキ 20 シ) バレレート、ジー t - ブチルバーオキシイソフタレ ート、α、α' ビス ( t – ブチルパーオキシ) ジイソプ ロピルベンゼン、ジクミルパーオキサイド、2.5-ジ メチル-2, 5-ジ (t-ブチルパーオキシ) ヘキサ ン、tープチルクミルパーオキサイド、ジーtープチル パーオキサイド、p-メンタンヒドロパーオキサイド、 シ) ヘキシン-3、ジイソプロピルベンゼンヒドロバー オキサイド、t-ブチルトリメチルシリルパーオキサイ ド、1, 1, 3, 3-テトラメチルプチルヒドロパーオ キシエチルパーオキシジカーボネート、ジ(2-エチル 30 キサイド、クメンヒドロパーオキサイド、 t-ヘキシル ヒドロパーオキサイド、t-ブチルヒドロパーオキサイ ド、2、3-ジメチル-2、3-ジフェニルブタン等を 挙げることができる。ラジカル発生剤の配合量は、重合 体100重量部に対し、0.1~10重量部が好まし い。これらは1種あるいは2種以上を同時に使用しても 良い。

【0040】トリアゼン化合物としては、例えば、1. 2-ビス(3, 3-ジメチルトリアゼニル)ベンゼン、 1、3-ビス(3、3-ジメチルトリアゼニル)ベンゼ サイド、1、1、3、3-テトラメチルプチルパーオキ 40 ン、1、4-ビス(3、3-ジメチルトリアゼニル) ベ ンゼン、ビス(3,3-ジメチルトリアゼニルフェニ ル) エーテル、ビス(3,3-ジメチルトリアゼニルフ ェニル) メタン、ビス(3,3-ジメチルトリアゼニル フェニル)スルホン、ビス(3,3-ジメチルトリアゼ ニルフェニル)スルフィド、2,2-ビス[4-(3. 3-ジメチルトリアゼニルフェノキシ)フェニル)-1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン、 2, 2-ビス〔4-(3, 3-ジメチルトリアゼニルフ ェノキシ)フェニル]プロパン、1,3,5-トリス (3,3-ジメチルトリアゼニル)ベンゼン、2,7-

\* などの雰囲気を選択することができる。このようにして得られる本発明のシリカ系膜は、膜密度が、通常、0.  $35\sim1$ .  $2\,\mathrm{g/c\,m^3}$ 、好ましくは0.  $4\sim1$ .  $1\,\mathrm{g}$ 

 $/cm^3$ 、さらに好ましくは $0.5\sim1.0g/cm^3$ である。膜密度が $0.35g/cm^3$ 未満では、塗膜の機械的強度が低下し、 $-方、1.2g/cm^3$ を超えると低比誘電率が得られない。また、本発明のシリカ系膜

は、BJH法による細孔分布測定において、10nm以上の空孔が認められず、微細配線間の層間絶縁膜材料と

-4-(3,3-ジメチルトリアゼニル)フェニル]フ 10 して好ましい。さらに、本発明のシリカ系膜は、吸水性ルオレン、2 7-ピス(3,3-ジメチルトリアゼニ かばいたに性がよった。 (2,3-ジメチルトリアゼニ かばいたに性がよった。 (2,3-ジメチルトリアゼニ )

が低い点に特徴を有し、例えば、塗膜を127℃、2. 5 a t m、100%RHの環境に1時間放置した場合、

放置後の塗膜の1Rスペクトル観察からは塗膜への水の 吸着は認められない。この吸水性は、本発明における膜 形成用組成物に用いられる化合物(1)のテトラアルコ

キシシラン類の量により、調整することができる。さらに、本発明のシリカ系膜の比誘電率は、通常、2.6~

1. 2、好ましくは2. 5~1. 2、さらに好ましくは

2. 4~1. 2である。

20 【0043】このようにして得られる層間絶縁膜は、塗膜の比誘電率の温度依存性が小さく、PCT後の比誘電率変化が少なく、かつ塗膜の機械的強度に優れることから、LSI、システムLシ、DRAM、SDRAM、RDRAM、D-RDRAMなどの半導体素子用層間絶縁膜やエッチングストッパー膜、半導体素子の表面コート膜などの保護膜、多層レジストを用いた半導体作製工程の中間層、多層配線基板の層間絶縁膜、液晶表示素子用の保護膜や絶縁膜などの用途に有用である。

【0044】

(実施例】以下、本発明を実施例を挙げてさらに具体的に説明する。ただし、以下の記載は、本発明の態様例を概括的に示すものであり、特に理由なく、かかる記載により本発明は限定されるものではない。なお、実施例および比較例中の部および%は、特記しない限り、それぞれ重量部および重量%であることを示している。また、各種の評価は、次のようにして行なった。

【0045】慣性半径

下記条件によるゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)(屈折率,粘度,光散乱測定)法により測40 定した。

試料溶液:シラン化合物の加水分解縮合物を、固形分濃度が0.25%となるように、10mMのLiBrを含むメタノールで希釈し、GPC(屈折率、粘度、光散乱測定)用試料溶液とした。

ピス(3,3-ジメチルトリアゼニル)-9,9-ピス [4-(3, 3-ジメチルトリアゼニル) フェニル] フ ルオレン、2, 7-ビス(3, 3-ジメチルトリアゼニ ル) -9, 9-ピス[3-メチル-4-(3, 3-ジメ チルトリアゼニル)フェニル]フルオレン、2.7-ビ ス(3, 3-ジメチルトリアゼニル)-9, 9-ビス [3-7x-10-4-(3,3-5)x+10+17-6]ル) フェニル] フルオレン、2、7-ビス(3、3-ジ メチルトリアゼニル) -9, 9-ビス[3-プロペニル ルオレン、2、7-ビス(3、3-ジメチルトリアゼニ ル) -9, 9-ビス[3-フルオロ-4-(3, 3-ジ メチルトリアゼニル)フェニル]フルオレン、2,7-ビス(3,3-ジメチルトリアゼニル)-9,9-ビス [3,5-ジフルオロー4-(3,3-ジメチルトリア ゼニル) フェニル] フルオレン、2, 7-ビス(3, 3 -ジメチルトリアゼニル) -9, 9-ビス「3-トリフ ルオロメチル-4-(3,3-ジメチルトリアゼニル) フェニル] フルオレンなどが挙げられる。 これらは1種

あるいは2種以上を同時に使用しても良い。 20【0041】とのようにして得られる本発明の組成物の全固形分濃度は、好ましくは、2~30重量%であり、使用目的に応じて適宜調整される。組成物の全固形分濃度が2~30重量%であると、塗膜の膜厚が適当な範囲となり、保存安定性もより優れるものである。なお、との全固形分濃度の調整は、必要であれば、濃縮および上記有機溶剤による希釈によって行われる。本発明の組成物を、シリコンウエハ、SiO、ウエハ、SiNウエハなどの基材に塗布する際には、スピンコート、浸漬法、ロールコート法、スプレー法などの塗装手段が用いられる。

【0042】この際の膜厚は、乾燥膜厚として、1回塗りで厚さ0.05~2.5μm程度、2回塗りでは厚さ0.1~5.0μm程度の塗膜を形成することができる。その後、常温で乾燥するか、あるいは80~600℃程度の温度で、通常、5~240分程度加熱して乾燥することにより、ガラス質または巨大高分子の絶縁膜を形成することができる。この際の加熱方法としては、ホットブレート、オーブン、ファーネスなどを使用することが出来、加熱雰囲気としては、大気下、窒素雰囲気、アルゴン雰囲気、真空下、酸素濃度をコントロールした減圧下などで行うことができる。また、電子線や紫外線を照射することによっても塗膜を形成させることができる。また、上記塗膜の硬化速度を制御するため、必要に応じて、段階的に加熱したり、窒素、空気、酸素、減圧\*

装置: 東ソー (株) 製、GPCシステム モデル GPC-8020 東ソー (株) 製、カラム Alpha5000/3000 ビスコテック社製、粘度検出器および光散乱検出器 モデル T-60 デュアルメーター

キャリア溶液: 10 mMのLiBrを含むメタノール

キャリア送液速度: lml/min · カラム温度:40℃

## 【0046】比誘電率の温度依存

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で80℃で2分 間、窒素雰囲気200℃で2分間基板を乾燥し、さらに 415℃の窒素雰囲気のホットプレートで30分間基板 を焼成した。この膜に対して、実施例に示すシリコン化 合物による表面処理を行った。得られた膜に対して蒸着 法によりアルミニウム電極パターンを形成させ比誘電率 10 測定用サンブルを作成した。該サンブル温度23℃、湿 度50%のクリーンルーム内に2週間放置した後、周波 数100kHzの周波数で、横河・ヒューレットパッカ ード(株) 製、HP16451B電極およびHP428 4AプレシジョンLCRメータを用いてCV法により当 該塗膜の23℃および200℃における比誘電率を測定 した。

## 【0047】PCT後の比誘電率

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で80℃で2分 20 合成例1において、25%水酸化テトラメチルアンモニ 間、窒素雰囲気200℃で2分間基板を乾燥し、さらに 420°Cの真空雰囲気のホットプレートで25分間基板 を焼成した。得られた膜に対して110℃、湿度100 %RH、2気圧の条件でPCTを1時間行い、蒸着法に よりアルミニウム電極バターンを形成させ比誘電率測定 用サンプルを作成した。該サンプルを周波数100kH 2の周波数で、横河・ヒューレットパッカード(株) 製、HP16451B電極およびHP4284Aプレシ ジョンLCRメータを用いてCV法により当該塗膜の比 誘電率を測定した。

## 【0048】塗膜の機械的強度(弾性率)

8 インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で80℃で2分 間、窒素雰囲気200℃で2分間基板を乾燥し、さらに 420℃の真空雰囲気のホットプレートで25分間基板 を焼成した。得られた膜の弾性率は、ナノインデンター XP(ナノインスツルメント社製)を用いて、連続剛性 測定法により測定した。

### 【0049】実施例1

石英製セパラブルフラスコに、エタノール471g、イ オン交換水237gと25%水酸化テトラメチルアンモ ニウム水溶液17.2gを入れ、均一に攪拌した。との 溶液にメチルトリメトキシシラン44.9gとテトラエ トキシシラン68.6gの混合物を添加した。溶液を5 5℃に保ったまま、2時間反応を行った。この溶液に2 0%マレイン酸水溶液28gとプロピレングリコールモ ノプロピルエーテル440gを加え、その後、50℃の エバポレーターを用いて溶液を10%(完全加水分解縮 合物換算)となるまで濃縮した。この溶液に酢酸エチル 300gとイオン交換水300gを添加し、液々抽出を 50

行った。上層の溶液を取り出し、50℃のエバポレータ ーを用いて溶液を10%(完全加水分解縮合物換算)と なるまで濃縮し、反応液Φを得た。このようにして得ら れた縮合物等の慣性半径は、20.3 nmであった。と の溶液を0.2μm孔径のテフロン(登録商標)製フィ ルターでろ過を行い本発明の膜形成用組成物を得た。得 られた組成物をスピンコート法でシリコンウエハ上に塗 布後焼成することで塗膜を得た。本塗膜の評価結果を表 1 に示す。

42

## 【0050】実施例2

合成例1において、25%水酸化テトラメチルアンモニ ウム水溶液の代わりに25%酢酸アンモニウム水溶液を 使用した以外は合成例1と同様にして、反応液②を得 た。とのようにして得られた縮合物等の慣性半径は、1 7.5 n mであった。この溶液を実施例1と同様にして 評価行った。本塗膜の評価結果を表1に示す。

## 【0051】実施例3

ウム水溶液の代わりに25%マレイン酸テトラメチルア ンモニウム水溶液を使用した以外は合成例1と同様にし て、反応液のを得た。このようにして得られた縮合物等 の慣性半径は、21.3nmであった。この溶液を実施 例1と同様にして評価行った。本塗膜の評価結果を表1 に示す。

## 【0052】実施例4

合成例1において、25%水酸化テトラメチルアンモニ ウム水溶液の代わりに25%酢酸ピリジニウム水溶液を 30 使用した以外は合成例1と同様にして、反応液のを得 た。このようにして得られた縮合物等の慣性半径は、1 5.3 n mであった。この溶液を実施例1と同様にして 評価行った。本塗膜の評価結果を表1に示す。

## 【0053】実施例5

合成例1において、25%水酸化テトラメチルアンモニ ウム水溶液の代わりに25%ジアザビシクロウンデセン 酢酸塩水溶液を使用した以外は合成例1と同様にして、 反応液⑤を得た。このようにして得られた縮合物等の慣 性半径は、19.7 nmであった。この溶液を実施例1 と同様にして評価行った。本塗膜の評価結果を表1に示

## 【0054】実施例6

合成例1において、25%水酸化テトラメチルアンモニ ウム水溶液の代わりに25%塩化テトラメチルアンモニ ウム水溶液を使用した以外は合成例1と同様にして、反 応液⑥を得た。このようにして得られた縮合物等の慣性 半径は、18.7 n m であった。この溶液を実施例1と 同様にして評価行った。本塗膜の評価結果を表1に示

## 【0055】比較例1

合成例1において、25%水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液の代わりに25%酢酸水溶液を使用した以外は合成例1と同様にして、反応液のを得た。このようにして得られた縮合物等の慣性半径は、0.2nmであっ\*

\*た。この溶液を実施例1と同様にして評価行った。本塗 膜の評価結果を表1に示す。

[0056]

【表1】

	反応液	比誘電率の	比誘電率の温度依存性		塗膜の
		23℃	200℃	比誘電率	弹性率(GPa)
実施例1	反応被①	2. 21	2. 16	2. 22	5. 8
実施例2	反応液②	2. 33	2. 36	2. 35	6. 5
実施例3	反応被③	2. 19	2. 12	2. 23	5. 3
実施例4	反応液④	2. 44	2. 40	2. 46	8. 5
実施例5	反応被⑤	2. 24	2. 1.9	2. 26	5. 9
実施例6	反応被⑥	2. 28	2. 24	2. 29	6. 1
比較例1	反応液⑦	3.04	2. 60	3. 45	4. 6

## [0057]

【発明の効果】本発明によれば、窒素オニウム塩化合 電率変化物、沸点100℃以下のアルコール、水の存在下アルコ 成用組成キシシラン加水分解および/または縮合を行うことで、※20 である。

※塗膜の比誘電率の温度依存性が小さく、PCT後の比誘 電率変化が少なく、かつ塗膜の機械的強度に優れた膜形 成用風成物(層間絶縁膜用材料)を提供することが可能

## フロントページの続き

(51)Int.Cl.'	識別記号	Fl	•	5 mm 1" (45.44)
	BBQ// 7BL -7			テーマコード(参考)
C 0 8 K 5/17		C08K	5/17	
C O 8 L 83/04		C08L 8	83/04	•
C 0 9 D 183/02	•	C09D 18	83/02	
183/14		18	83/14	•
Fターム(参考) 4J002 C	P031 CP051 CP081 DE027			

DF006 EC037 EC038 EC048

EE038 EE048 EH008 EH038

EH098 EH148 EH158 EN136

EP018 EU046 EU056 EU076

EU118 EU136 EU138 EU206

EU238 EV256 EW046 FD310

4J035 AA02 AA03 AA05 AB02 BA02

BA03 BA04 BA05 BA06 BA12

BA13 BA14 BA15 BA16 CA061

CA112 CA132 CA152 EA01

EB04 HA01 HA02 LB20

4J038 DL021 DL031 DL041 DL161

GA01 GA02 GA03 GA06 GA07

GA08 GA12 GA13 JA19 JA20

JA22 JA26 JA27 JA33 JA43

JA56 JB01 JB11 JB13 JB25

JB29 JB30 JC17 KA03 KA06

LA03 MA08 MA10 NA11 NA21

PA19 PB09